МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Справочная серия

Выпуск 678

В. Ф. Леонтьев

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



«ЭНЕРГИЯ»

МОСКВА 1969

6Ф2.13
Л 47
УДК 621.382.3

Леонтьев В. Ф.

Л47 «Зарубежные транзисторы широкого применения». М., «Энергия», 1968

88 с. с илл. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 678)

В брошюре содержатся справочные сведения (параметры и чертежи корпусов) о наиболее распространенных типах транзисторов США, Японии, ГДР и ФРГ.

Справочник предназначен для широкого круга радиолюбителей.

3-4-5
384-69

6 Ф2.13

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот справочник предназначен для широкого круга радиолюбителей. Он ставит своей целью познакомить читателей лишь с основными параметрами ряда зарубежных транзисторов широкого применения.

В справочнике приведены параметры транзисторов Японии, США, ФРГ и ГДР. Все данные о транзисторах сведены в таблицы. При пользовании таблицами следует обратить внимание на то, что в некоторых графах приведены значения нескольких параметров. Их надо различать по соответствующим знакам и в самих таблицах: если в шапке таблицы параметр обозначен, например, одной или двумя звездочками, то соответствующее ему значение в таблице также отмечено одной или двумя звездочками. Если в таблице значение параметра приведено в скобках, то это соответствует размерности параметра в шапке таблицы, также заключенной в скобки.

В графе *Дополнительные сведения* приводятся следующие параметры: коэффициент шума в *дб*; тепловое сопротивление между переходом и корпусом в *°С/вт*; времена включения, выключения и время нарастания переднего фронта импульса тока коллектора в *мксек*; начальный ток коллектора в *ма*.

В справочнике используются сокращенные обозначения типовых (тип.) или импульсных (имп.) значений параметров.

Для транзисторов ГДР приведены предельные значения напряжений, а не пробивные.

В справочнике приняты следующие условные обозначения:

Ge — германий;

Si — кремний;

$P_к$ — максимальная мощность, рассеиваемая коллектором;

$f_{h21б}$ — граничная частота передачи тока в схеме с общей базой;

$f_т$ — максимальная частота передачи тока (произведение коэффициента передачи тока на частоту измерения);

$f_{h21э}$ — граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером;

$f_{макс}$ — максимальная частота генерации;

$t_п$ — максимальная температура перехода;

$U_{(проб)\ к.б0}$ — пробивное напряжение коллектор — база при разомкнутой цепи эмиттера;

$U_{(проб)\ к.э0}$ — пробивное напряжение коллектор — эмиттер при разомкнутой цепи базы;

$U_{(проб)\ э.б0}$ — пробивное напряжение эмиттер — база при разомкнутой цепи коллектора;

$I_к$ — ток коллектора;

$I_э$ — ток эмиттера;

$I_б$ — ток базы;

$I_{к.б0}$ — обратный ток коллектора (при разомкнутой цепи эмиттера);
$I_{к.н.}$ — начальный ток коллектора;
$U_{к.б}$ — постоянное напряжение коллектор — база;
$U_{к.э}$ — постоянное напряжение коллектор — эмиттер;
$h_{21э}$ — коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером;
$h^*_{21э}$ — коэффициент передачи тока в режиме большого сигнала в схеме с общим эмиттером;
$C_к$ — емкость коллекторного перехода;
$F_ш$ — коэффициент шума;
$R_{п.к}$ — тепловое сопротивление между переходом и корпусом;
$t_ф$ — время нарастания переднего фронта импульса тока коллектора;
$t_{вкл}$ — время включения;
$t_{выкл}$ — время выключения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_К$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^{*}_{т}$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^{*}_{(проб)к.э\ 0}$, в	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)э.б\ 0}$, в	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $I_к$; $I^{*}_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б\ 0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^{*}_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^{*}_{к.э}$, в	$h_{21э}$; $h^{*}_{21Э}$ при $I_э$; $I^{*}_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
Транзисторы Японии															
2SA12	Ge, *p-n-p*	80	8	85	16	0,5	15	6	12	6*	1	55	33	$t_ф = 0,43$	TO1
2SA15	То же	80	12	85	16	0,5	15	6	12	6*	1	60	32	$t_{выкл} = 0,65$	TO1
2SA17	» »	80	19	85	16, 10*	12	15	4	10	6*	1	70—200*	9,5	$t_ф = 0,43$ $t_{выкл} = 0,65$	TO1
2SA18	» »	80	19	85	21. 12*	12	15	7	12	6*	1	70—300*	9,5	—	TO1
2SA28	» »	55	8	75	18, 18*	0,5	5	8	12	6	1	30	6,0	—	TO44
2SA37	» »	25	7*	75	18*	—	5	10	12	6	1	70	11	—	—
2SA38	» »	25	10	75	18*	—	5	10	12	6	1	70	11	—	—
2SA49 (2S49)	» »	60	10	75	18, 18*	12	5	12	18	6	1	70	11	—	TO1
2SA50 (2S50)	» »	55	14	75	18, 16*	12	24	3	12	1*	24*	70*	10	—	TO1
2SA52 (2S52)	» »	60	7	75	18, 18*	12	5	12	18	6	1	70	11	—	TO1
2SA53 (2S53)	» »	60	5	75	18	12	5	12	18	6	1	49	11	—	TO1
2SA57 (2S57)	» »	55	85	75	18, 18*	12	5	12	18	9	1	80	2,5	—	TO44
2SA58 (2S58)	» »	55	75	75	18, 18*	0,5	5	12	18	9	1	80	1,7	—	TO44
2SA60 (2S60)	» »	55	55	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6	1	70	1,9	—	TO44
2SA65	» »	150	6	75	18, 18*	12	200	7	12	0,5*	100*	80	16	—	TO1
2SA66	» »	150	10	75	18, 18*	12	200	7	12	0,5*	100*	80	16	—	TO1
2SA67	» »	150	14	75	18, 18*	12	200	7	12	0,5*	100*	80*	16	—	TO1
2SA69	» »	100	70	75	20, 15*	0,5	10	13	—	6*	1	150	4,0	—	TO7
2SA70	» »	100	70	75	20, 15*	0,5	10	13	—	6*	1	150	3,5	—	TO7
2SA71	» »	100	100	75	20, 15*	0,5	10	13	—	6	1	150	2,5	—	TO7
2SA72	» »	55	40	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6*	1	19	6,0	—	TO44
2SA74	» »	125	70	75	50	0,5	5	8	12	6	5	70	2,2	—	TO44
2SA75	» »	120	30	75	20, 20*	0,5	50	8	12	3	20	70	6,0	—	TO44
2SA76	» »	55	130	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6	1	70	1,7	—	TO44
2SA77	» »	55	110	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6	1	70	1,7	—	TO44
2SA78	» »	125	25	75	40, 40*	2,0	400	8	12	6	1	70	6,0	—	TO44

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SA92 (2S92)	Ge, *p-n-p*	55	50	75	18, 18*	0,5	5	12	18	4,5	1	70	2,0	—	TO44
2SA93 (2S93)	То же	55	45	75	18, 18*	0,5	5	12	18	4,5	1	50	2,0	—	TO44
2SA106	» »	35	30	85	6, 6*	—	10	10	—	3,0	1*	50	—	—	TO44
2SA107	» »	35	20	85	6, 6*	—	10	10	—	3,0	1*	40	—	—	TO44
2SA113	» »	50	20	85	34, 25*	—	10	7	—	12	1*	45	—	—	TO44
2SA114	» »	50	20	85	34, 25*	—	10	7	—	12	1*	40	—	—	TO44
2SA121	» »	15	100	65	15, 15*	—	2	8	15	6,0	1	24	1,3	—	RO14
2SA122	» »	15	100	65	15, 15*	—	2	8	15	6,0	1	24	1,3	—	RO14
2SA124	» »	15	120	65	15, 15*	—	2	8	15	6,0	1	14—82	1,3	—	RO14
2SA125	» »	15	120	65	15, 15*	—	2	2	15	6,0	1	32—66	1,3	—	RO14
2SA128	» »	170	20	75	40, 40*	2,0	500	50	12	1,5	600	15—50*	20	—	TO44
2SA129	» »	170	20	75	40, 40*	—	500	50	12	1,5	600	40—180*	20	—	TO44
2SA136	» »	80	10	85	6, 6*	0,5	10	10	—	3,0*	1*	75	13	—	TO1
2SA137	» »	80	5	85	6, 6*	0,5	10	10	—	3,0*	1*	50	—	—	TO1
2SA161	» »	50	500*	85	20*, 20	—	15	5	15	6	20	13	1,2	—	TO18
2SA162	» »	50	500*	85	20*, 20	—	15	5	15	6	20	24	1,2	—	TO18
2SA163	» »	50	500*	85	20, 15*	—	15	5	15	6	20	⩽66	1,2	—	TO18
2SA165	» »	50	500*	85	20, 15*	—	15	5	15	6	20	⩽25	1,2	—	TO18
2SA166	» »	50	500*	85	20, 15*	—	15	5	15	6	20	⩾66	1,2	—	TO18
2SA175 (2S175)	» »	55	85	75	18, 18*	0,5	5	12	18	9	1	80	1,7	—	TO44
2SA183	» »	50	16	70	15, 12*	15	10	10	—	6	1	30	13	—	TO1
2SA204	» »	150	6	65	30, 10*	20	200	6	—	6	1	65	15	—	TO5
2SA208	» »	120	3	85	20, 15*	12	400	5	12	0,3	200	15—100*	25	$t_ф = 0,44$ $t_{выкл} = 0,7$	TO5
2SA209	» »	120	5	85	20, 15*	12	400	5	12	0,3	200	30—120*	25	$t_{вкл} = 0,75$ $t_{выкл} = 0,37$	TO5
2SA210	» »	120	10	85	20, 15*	12	400	5	12	0,3	200	45—150*	25	$t_ф = 0,2$ $t_{выкл} = 0,55$	TO5
2SA211	» »	120	4	85	18, 12*	10	100	10	12	0,3	100	30—120*	20	$t_ф = 0,4$ $t_{выкл} = 0,6$	TO5
2SA212	» »	120	4	85	25, 15*	15	100	5	12	0,3	100	30—120*	20	$t_ф = 0,4$ $t_{выкл} = 0,6$	TO5
2SA214	» »	15	140	50	15, 12*	0,5	2	5	—	6*	1	25	1	—	TO1

Продолжение

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_К$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	$I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SA215	Ge, p-n-p	15	120	50	15, 12*	0,5	2	5	—	6*	1	40	1	—	TO1
2SA216	То же	15	120	50	15, 12*	0,5	2	5	—	6*	1	40	1	—	TO1
2SA217	» »	120	14	85	25, 15*	12	100	5	12	0,3	100	30—120*	20	$t_{вкл} = 0,33$; $t_{выкл} = 0,55$	TO5
2SA218	» »	50	25	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	48	2,5	—	TO44
2SA219	» »	50	40	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	50	2,5	—	TO44
2SA220	» »	50	50	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	150	3,0	—	TO44
2SA221	» »	50	50	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	75	2,5	—	TO44
2SA223	» »	50	64	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	50	2,5	—	TO44
2SA225	» »	50	100	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	80	3,0	—	TO44
2SA227	» »	50	80	70	20, 15*	0,5	10	12	—	6	1	60	3,0	—	TO44
2SA229	» »	75	750	75	20, 18*	0,2	5	10	12	6	2	10	1,0	—	TO17
2SA230	» »	75	750	75	20, 18*	0,2	5	10	12	6	2	10	1,0	—	TO17
2SA234	» »	80	120	85	20, 18*	0,5	10	30	18	6*	1	70	2,1	—	TO44
2SA235	» »	80	135	85	20, 18*	0,5	10	30	18	6*	1	90	2,1	—	TO44
2SA236	» »	55	35	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6	1	50	1,7	—	TO44
2SA237	» »	55	35	75	18, 18*	0,5	5	12	18	6	1	50	1,7	—	TO44
2SA239	» »	75	300	75	20, 18*	0,2	5	10	12	6	2	10	1,5	—	TO17
2SA240	» »	75	300	75	20, 18*	0,2	5	10	12	6	2	20	1,5	—	TO17
2SA241	» »	50	≥230*	70	20*	0,4	5	13	—	6	1	100	1,0	—	TO7
2SA242	» »	50	≥290*	70	20*	0,4	5	13	—	6	1	100	1,0	—	TO7
2SA243	» »	50	≥350*	70	20*	0,4	5	13	—	6	1	100	1,0	—	TO7
2SA246	» »	100	155	85	30, 25*	0,5	30	30	25	6*	5	70	2,5	—	TO44
2SA247	» »	100	200	85	10	0,5	30	5	10	0,3	20	125* (тип.)	5,5	$t_ф = 0,03$; $t_{выкл} = 0,52$	TO44
2SA248	» »	125	25	75	40	2,0	200	12	12	1	200	50*	3,5	$t_ф = 0,03$	TO44
2SA251	» »	50	50	70	15, 6*	15	50	5	—	1*	15*	50*	2,5	$t_ф = 0,15$; $t_{выкл} = 0,38$	RO48
2SA252	» »	50	80	70	15, 6*	15	50	5	—	1*	15*	150*	2,5	$t_ф = 0,12$; $t_{выкл} = 0,32$	RO48
2SA276	» »	75	210*	75	15	2,0	20	5	12	0,5*	10*	60*	3,5	—	TO17
2SA277	» »	65	≥3,5	75	18	12	40	3	12	1*	24*	50*	10	—	TO9
2SA278	» »	65	≥11	75	18	12	40	3	12	1*	24*	100*	10	—	TO9
2SA282	» »	150	6,0	75	18	12	200	7	12	0,5*	100*	80*	10	—	TO9
2SA283	» »	150	10	75	18	12	200	7	12	0,5*	100*	80*	10	—	TO9
2SA284	» »	150	14	75	18	12	200	7	12	0,5*	100*	80*	10	—	TO9

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SA288	Ge, *p-n-p*	80	⩾250*	85	20	0,5	10	30	18	6*	3	⩾10	1,2	—	TO7
2SA289	То же	80	⩾250*	85	20	0,5	10	30	18	6*	3	⩾10	1,2	—	TO7
2SA290	» »	80	⩾250*	85	20	0,5	10	30	18	6*	3	⩾10	1,2	—	TO7
2SA291	» »	50	100	70	20	—	50	5	—	6*	4	40	1,5	—	RO48
2SA292	» »	50	200*	70	15	—	50	5	—	6*	4	40	1,5	—	RO48
2SA293	» »	50	300*	70	15	—	50	5	—	6*	4	40	1,5	—	RO48
2SA294	» »	50	400*	70	15	—	50	5	—	6*	4	40	1,5	—	RO48
2SA304	» »	65	4,5	75	18	12	40	4	12	6	1	70	11	—	TO9
2SA305	» »	65	10	75	18	12	40	4	12	6	1	70	11	—	TO9
2SA311	» »	150	60	75	40	2,0	400	6	12	1*	400*	60	3,0	$t_ф = 0,27$	TO9
2SA312	» »	150	60	75	40	2,0	400	6	12	1*	200*	60	3,0	$t_ф = 0,1$	TO9
2SA313	» »	60	40	75	18	0,5	5	6	10	6*	1	60	2,0	$F_ш = 15$	TO9
2SA314	» »	60	40	75	18	0,5	5	6	12	6*	1	100	2,0	$F_ш = 15$	TO9
2SA315	» »	60	55	75	18	0,5	5	6	12	6*	1	110	2,0	$F_ш = 15$	TO9
2SA316	» »	60	75	75	18	0,5	5	6	12	6*	1	110	2,0	$F_ш = 15$	TO9
2SA321	» »	50	25	70	20	0,5	10	12	—	6	1	40	3,0	—	TO44
2SA323	» »	50	35	70	20	0,5	10	12	—	6	1	50	3,0	—	TO44
2SA338	» »	50	20	70	20	0,5	5	16	—	6	1	30	2,5	—	RO18
2SA350	» »	80	50	85	20	0,5	10	10	12	9*	1	90	2,5	—	TO1
2SA351	» »	80	35	85	20	0,5	10	10	12	9*	1	70	2,5	—	TO1
2SA352	» »	80	40	85	20	0,5	10	10	12	9*	1	75	2,5	—	TO1
2SA353	» »	80	35	85	25	0,5	10	10	12	9*	1	70	2,5	—	TO1
2SA354	» »	80	35	85	25	0,5	10	10	12	9*	1	70	2,5	—	TO1
2SA355	» »	80	40	85	25	0,5	10	10	12	9*	1	90	2,5	—	TO1
2SA372	» »	100	⩾350*	70	15,15*	1	200	10	—	1*	10*	20*	3,5	$t_{вкл} = 0,006$ $t_{выкл} = 0,045$	TO18
2SA377	» »	50	⩾230*	70	20*	2,0	5	13	—	6	1	100	1,0	—	RO38
2SA378	» »	50	⩾290*	70	20*	0,4	5	13	—	6	1	100	1,0	—	RO38
2SA379	» »	50	⩾350*	70	20*	0,4	5	13	—	6	1	100	1,0	—	RO38
2SA401	» »	125	230	85	30	0,5	40	30	30	6*	1	70	3,0	—	TO44
2SA408	» »	50	50	70	15,6*	15	50	5	—	1*	15*	100*	3,0	$t_ф = 0,105$ $t_{выкл} = 0,23$	RO48
2SA409	» »	50	80	70	15,6*	15	50	5	—	1*	15*	100*	3,0	$t_ф = 0,09$ $t_{выкл} = 0,16$	RO48
2SA410	» »	150	300*	85	15	1,0	150	5	—	0,3	10	40*	1,5	$t_{вкл} = 0,06$ $t_{выкл} = 0,15$	TO18

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C			$I_{к.б0}$; мка (ма)		$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$			$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
					$U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)		при $U_{к.б}$, в	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)				
2SA411	Ge, p-n-p	150	400*	85	15,15*	2,5	150	5	—	0,3	10	40*	1,5	$t_{вкл} = 0,05$; $t_{выкл} = 0,125$	TO18
2SA412	То же	150	60*	85	12*	5	100	20	13	0,5	30	30*	12	$t_{вкл} = 0,28$; $t_{выкл} = 0,15$	TO1
2SA419	» »	50	≥350*	85	20,20*	0,5	5	10	—	6*	2	20	≤1,5	—	TO17
2SA420	» »	50	>300*	85	20,20*	0,5	5	10	—	6*	2	20	≤1,5	—	TO17
2SA421	» »	50	≥400*	85	20,20*	0,4	5	10	—	12*	2	25	≤1,2	—	TO17
2SA427	» »	100	45	85	20	—	15	15	—	6*	1*	60	≤5	—	TO44
2SA428	» »	100	50	85	20	—	15	15	—	6*	1*	80	≤5	—	TO44
2SA448	» »	40	100	75	15*	—	5	10	10	—	—	—	0,3	—	TO5
2SB25 (2S26A)	» »	(10)	0,25*	75	60	12	(1,5)	(2)	12	1,5	(1)*	34—110*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SB26 (2S26)	» »	(10)	0,25*	75	25	12	(1,5)	(16)	12	1,5	(1)*	34—110*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SB27	» »	(5)	0,007**	75	15,15**	10	500	(0,8)	—	1,5*	(0,2)*	18—46*	—	$R_{п.к} = 50$	TO3
2SB28	» »	(5)	0,007**	75	15,15**	10	500	(0,8)	—	1,5*	200	35—96*	—	$R_{п.к} = 50$	TO3
2SB29	» »	(5)	0,007**	75	15,15**	10	500	(0,8)	—	1,5*	200	72—186*	—	$R_{п.к} = 50$	TO3
2SB39	» »	50	0,85	75	10*	6	2	12	—	4	0,5	45	40	$F_ш \leq 8$	RO16
2SB40	» »	80	1,0	75	40	12	100	10	12	1	100	100*	—	—	TO1
2SB44	» »	80	0,5	75	25	12	50	10	12	6	1	110*	30	$F_ш = 8$	TO1
2SB46	» »	80	1,0	75	20*	12	150	5	12	6	1	150	35	$F_ш = 25$	TO1
2SB47	» »	80	1,0	75	25,20*	12	50	14	20	6	1	150	35	$F_ш = 4,5$	TO1
2SB48	» »	140	2,5	65	16,16*	—	100	16	—	1*	20	21—62*	25	$F_ш = 9—15$	TO5
2SB49	» »	140	3,0	65	16,16*	—	100	16	—	1*	20	38—110*	25	$F_ш = 12$	TO5
2SB50	» »	140	3,5	65	16,16*	—	100	16	—	1*	20	66—14*	25	$F_ш = 12$	TO5
2SB51	» »	200	2,0	85	30,20*	3	200	16	—	1*	20	21—62*	25	$F_ш = 12$	TO5
2SB52	» »	200	3,0	85	30,20*	3	200	16	—	1*	20	38—110*	35	$F_ш = 12$	TO5
2SB53	» »	200	3,0	85	30,25	15	250	10	—	1*	20	41—66*	35	$F_ш \leq 8$	
2SB54	» »	125	1,0	75	20,20*	12	50	14	20	6	1	150	35	$F_ш = 10$	TO5
2SB55	» »	150	1,0	75	60,60*	12	50	20	25	1,0	50	80*	25	—	TO1
2SB56	» »	150	1,0	75	25,20*	12	50	14	25	1,0	50	80*	25	—	TO1
2SB59	» »	150	1	85	30,20*	10	100	15	25	1*	50*	70*	—	—	TO1
2SB60	» »	150	1	85	20,15*	2,5	50	14	20	6	1	65	—	—	TO1
2SB61	» »	150	1	85	30,20*	—	50	10	30	6	1*	50	50	—	RO16
2SB62	» »	(4)	0,3**	75	60	12	500	70	12	1,0	500*	30—124*	—	$R_{п.к} = 10$	MD10
2SB63	» »	(5)	0,3**	75	32	12	500	70	12	1,0	500*	30—125*	—	$R_{п.к} = 10$	MD10

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, *в*	$U_{(проб)э.б0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$; *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SB64	Ge, *p-n-p*	(25)	1	75	100	1	(6)	330	12	1,5*	(1)*	34—160*	—	$R_{п.к} = 2$	TO3
2SB65	То же	150	1	85	30,25*	12	100	15	30	6	1*	65	35	$t_ф = 3$	RO16
2SB66	» »	150	1,5	85	30,25*	12	70	14	30	6*	1	70	32	—	TO1
2SB67	» »	350	1	70	55	12	150	10	30	6*	1	45	45	—	TO1
2SB67A	» »	350	1	70	60	30	150	10	30	6*	1	45	45	—	TO1
2SB68	» »	50	0,5	85	105,90*	50	100	14	25	0,35	5	20—60* (тип.)	45	—	TO5
2SB69	» »	(25)	1	70	60	1	(6)	330	60	1,5*	(1)*	34—160	—	$R_{п.к} = 2$	TO3
2SB73	» »	50	2,0	85	10	10	2	7	12	4*	0,5	80	—	$F_ш = 3,5$	TO1
2SB75	» »	150	2,0	85	25,20*	12	100	14	30	6*	1	55	—	$F_ш = 7$	TO1
2SB75A	» »	150	2,0	85	45,40*	12	100	25	40	6*	1	55	—	$F_ш = 7$	TO1
2SB77	» »	150	—	85	25	12	100	14	30	6*	1*	70	—	—	TO1
2SB77A	» »	150	—	85	45	25	100	25	45	6*	1*	70	—	—	TO1
2SB89	» »	250	—	85	25	12	150	16	30	1	150	65	—	—	RO27
2SB89A	» »	250	—	85	45	12	150	50	45	1	150	65	—	—	RO27
2SB90	» »	40	1,0	75	18	—	50	14	18	6	1	150	12	$F_ш = 10$	—
2SB91	» »	40	1,0	75	18	—	5	14	18	6	1	70	—	—	—
2SB97	» »	40	—	75	18	12	5	14	30	6	1	70	12	$F_ш = 7$	TO2
2SB122	» »	(25)	0,25	75	80	40	(1,5)	(120)	12	1,5	(1)*	34—110*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SB124	» »	(40)	0,3	70	60	25	(15)	(1,2)	12	1,5	(15)*	⩾70*	—	$R_{п.к} = 1,2$	MS1
2SB125	» »	(40)	0,3	70	36	25	(15)	(1,2)	12	1,5	(15)*	⩾70*	—	$R_{п.к} = 1,2$	MS1
2SB140	» »	(12)	0,007**	85	40,10*	12	(1,5)	15	12	1,5*	(1)*	62—89*	—	$R_{п.к} = 35$	TO3
2SB141	» »	(12)	0,007**	85	60,40*	12	(1,5)	150	12	1,5*	(1)*	62—89*	—	$R_{п.к} = 35$	TO3
2SB142	» »	(10)	0,007**	85	30,30*	—	(1)	(1)	—	1,5*	(1)*	12—31*	—	$R_{п.к} = 40$	TO3
2SB143	» »	(10)	0,007**	85	30,30*	12	(1)	(1)	—	1,5*	(1)*	23—59*	—	$R_{п.к} = 40$	TO3
2SB144	» »	(10)	0,007**	85	30,30*	12	(1)	(1)	—	1,5*	(1)*	45—119*	—	$R_{п.к} = 40$	TO3
2SB145	» »	(10)	0,007**	85	30	—	(1)	(1)	—	1,5*	(1)*	23—60*	—	$R_{п.к} = 6$	TO3
2SB146	» »	(10)	0,007**	85	30	—	(1)	(1)	—	1,5*	(1)*	45—119*	—	$R_{п.к} = 6$	TO3
2SB148	» »	(40)	0,3	70	80	—	(15)	(1,2)	12	1,5*	(1)*	43—190*	—	—	—
2SB149	» »	(25)	0,25	75	40	30	(8)	230	12	1,5	(5)*	⩾60*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2SB150	» »	50	0,5	75	105	50	40	50	105	1,5	5	60*	—	—	TO1
2SB156	» »	150	—	85	16,16*	2,5	300	14	12	4*	1	45	—	—	TO1
2SB156A	» »	150	—	85	20,20	6,0	300	14	12	4*	1	45	—	—	TO1
2SB189	» »	250	1,0	75	25	12	250	14	25	1	0,1*	75*	—	—	X5
2SB200	» »	500	0,5	75	32,32*	12	400	40	12	1	0,15	30—150*	—	$R_{п.к} = 100$	RO10
2SB201	» »	500	0,5	75	32	12	140	30	12	1	0,15	150*	—	—	TO9

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SB202	Ge, *p-n-p*	500	0,5*	75	32,32*	12	400	40	12	1	(0,15)	70—290*	—	$R_{п.к} = 100$	RO10
2SB203	То же	(80)	0,002**	85	40	—	(20)	(5)	40	1,5*	(15)*	20—40*	—	$R_{п.к} = 0,75$	MD18
2SB204	» »	(80)	0,002**	85	40	—	(30)	(5)	40	1,5*	(15)*	50—100*	—	$R_{п.к} = 0,75$	MD18
2SB205	» »	(80)	0,002**	85	80	—	(20)	(5)	80	1,5*	(15)*	20—40*	—	$R_{п.к} = 0,75$	MD18
2SB206	» »	(80)	0,002**	85	80	—	(30)	(5)	80	1,5*	(15)*	50—100*	—	$R_{п.к} = 0,75$	MD18
2SB231	» »	(25)	1,0	75	120,120*	1,0	(6)	300	12	1,5	(5)*	25—200*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2SB235	» »	(60)	0,2	85	80	25	(15)**	(1,2)	12	2,0*	(5)*	25—200*	—	$R_{п.к} = 1$	TO36
2SB236	» »	(60)	0,2	85	60	25	(15)**	(1,2)	12	2,0*	(5)*	25—200*	—	$R_{п.к} = 1$	TO36
2SB237	» »	(60)	0,2	85	36	25	(15)**	(1,2)	12	2,0*	(5)*	25—200*	—	$R_{п.к} = 1,0$	TO36
2SB264	» »	70	1	70	25	—	50	10	25	1,5*	0,5	65	15	—	TO1
2SB274	» »	(12)	—	90	80	1,5	(6)	(1)	30	1,5*	(1)	50 (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB275	» »	(12)	1	90	120,105*	1,5	(6)	(1)	30	1,5	(4)*	40 (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD21
2SB276	» »	(12)	1,0	90	120,105*	1,5	(10)	(1)	30	1,2*	(10)*	35* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB290	» »	65	1,0	75	18	12	40	4	12	6*	1*	125	9,5	$F_ш = 7$	TO9
2SB291	» »	150	1,0	75	30	12	150	10	12	6*	1	100	35	$F_ш = 8$	TO5
2SB292	» »	150	1,0	75	30,25*	12	0,15	0,001	12	1	0,05	85	35	То же	TO9
2SB293	» »	150	1,2	70	18	—	250	10	18	1*	150	70*	—	» »	TO1
2SB294	» »	150	1,2	70	18	—	250	10	18	4*	1	36	—	» »	TO1
2SB296	» »	(30)	1,5	75	160	3,0	(10)	330	12	1,5*	(10)*	25—200*	—	» »	MD6
2SB302	» »	40	12	85	10	5,0	2	6	12	6	1	80	10	$F_ш = 3,5$	TO1
2SB306	» »	75	0,9	75	105,105*	50	20	10	105	0,35*	2*	20—140*	—	То же	TO5
2SB321	» »	40	—	75	12	12	50	4	12	1,5*	0,5	100	—	$F_ш = 7$	RO68
2SB322	» »	40	—	75	12	12	50	4	12	1,5*	0,5	150	—	То же	RO68
2SB323	» »	40	—	75	12	12	50	4	12	1,5*	0,5	100	—	» »	RO68
2SB331	» »	(8,0)	0,35 *кгц**	100	40,25*	20	(15)	(4)	20	2	(5)*	20—125*	—	$R_{п.к} = 9,4$	TO36
2SB332	» »	(8,0)	0,35 *кгц**	100	60,45*	40	(15)	(4)	40	2	(5)*	20—125*	—	$R_{п.к} = 9,4$	TO36
2SB333	» »	(8,0)	0,35 *кгц**	100	80,55*	40	(15)	(4)	80	2	(5)*	25—70*	—	$R_{п.к} = 9,4$	TO36
2SB334	» »	(8,0)	0,35 *кгц**	100	100,65*	60	(15)	(4)	100	2	(5)*	25—50*	—	$P_{п.к} = 9,4$	TO36
2SB337	» »	(12)	0,25	90	40,25*	10	(7)	(1)	30	1,5*	(4)*	50* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB338	» »	(12)	0,25	90	60,30	10	(7)	(1)	30	1,5*	(4)*	50* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB339	» »	(12)	0,25	90	80,35*	50	(10)**	250	30	1*	(8)*	35* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB340	» »	(12)	0,25	90	100,40*	50	(10)**	250	30	1*	(8)*	35* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB341	» »	(12)	0,25	90	120,50*	50	(10)**	250	30	1*	(8)*	35* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB361	» »	(12)	≥0,05**	90	80,40*	1,0	(5)	500	40	2*	(4,5)*	90* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB362	» »	(12)	0,05**	90	100,40*	1,0	(7)	500	40	2*	(4,5)*	90* (тип.)	—	$R_{п.к} = 5,4$	MD24
2SB367	» »	(4)	0,5	85	25,20*	—	(1)	100	12	1,5*	(0,5)*	60* (тип.)	—	$R_{п.к} = 15$	—

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$; *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SB368	Ge, *p-n-p*	(4)	0,5	85	45,35*	—	(1)	100	12	1,5*	500*	110*(тип.)	—	$R_{п.к} = 15$	MD23
2SB370	То же	200	—	85	25	—	500	20	12	1	150	100	—	—	TO1
2SB370A	» »	200	—	85	32	12	500	20	12	1	150	100	—	—	TO1
2SB377	» »	270	⩾1,4	85	32	12	150	10	32	6	1	82—218	35	$F_ш = 4$	TO5
2SB378	» »	180	⩾1,3	65	18	—	150	10	18	6	1	19—60	35	$F_ш = 10$	TO5
2SB379	» »	180	⩾1,5	65	18	—	150	10	18	6	1	38—121	35	$F_ш = 10$	TO5
2SB380	» »	180	⩾1,7	65	18	—	150	10	18	6	1	76—242	35	То же	TO5
2SB381	» »	270	1,3	85	32	—	300	10	32	6	1	19—60	35	» »	TO5
2SB382	» »	270	1,5	85	32	—	300	10	38	6	1	38—121	35	» »	TO5
2SB383	» »	270	3,0	85	32	—	500	10	32	6	1	84*	35	» »	TO5
2SB391	» »	(30)	1,0	70	50	—	(6)	(5)	50	1,5*	(3)*	25—350*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2SB420	» »	(6)	—	100	105	1,0	(1,5)	250	12	—	—	—	—	—	—
2SB439	» »	150	2,0	70	30	12	150	14	30	6*	1	130	30	$F_ш = 9 \div 15$	TO1
2SB440	» »	150	2,0	70	30	12	150	14	30	6*	1	130	30	$F_ш \leqslant 8$	TO1
2SB446	» »	(10)	1,5*	85	60	1,0	(1,5)	(0,1)	60	2*	(1)*	40—200*	—	$R_{п.к} = 6$	MD10
2SC11	Ge, *n-p-n*	55	6,0	75	18	12	24	9	12	6*	1	22—150*	12	—	TO1
2SC12	Si, *n-p-n*	700	13*	150	60	8,0	250	10	30	10	200	20	—	—	TO9
2SC13	Ge, *n-p-n*	65	⩾3,5	75	18	12	40	9	12	1*	24*	50*	10	—	TO9
2SC14	То же	65	⩾11	75	18	12	40	9	12	1*	24*	100*	10	—	TO9
2SC16	Si, *n-p-n*	200	100	150	25	5,0	30	2,5	15	1*	10*	25*	4	—	TO18
2SC17	То же	200	50	150	25	5,0	50	2,5	12	6*	2*	30	4	—	TO18
2SC18	» »	200	⩾70	150	25	2,0	30	0,1	6	0,3*	0,1*	80*	7	$F_ш = 9 \div 15$	TO18
2SC19	» »	600	—	150	40	5,0	400	1	30	10*	150	50*	30	—	TO9
2SC20	» »	600	70	150	30	3,0	400	1	30	10	10	50	30	—	TO9
2SC21	» »	(60)	50	150	60	5,5	(2)	(1)	30	10	(1)*	25* (тип.)	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2SC41	» »	(50)	20	150	150	6,0	(5)	(60)	150	10*	(1)*	12—92*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SC42A	» »	(50)	20	150	200,75*	6,0	(5)	(30)	50	10*	(1)*	12—128*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SC43	» »	(50)	20	150	100	6,0	(5)	(30)	100	10*	(1)*	4—185*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SC44	» »	(50)	20	150	50	6,0	(5)	(30)	50	10*	(1)*	4—185*	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO3
2SC73	Ge, *n-p-n*	30	20	75	15	—	5	10	15	6	1	26—82	2,0	—	—
2SC74	Si, *n-p-n*	300	—	150	30	5,0	100	4	15	6*	2	50	3,5	—	TO9
2SC75	Ge, *n-p-n*	30	10	75	15	—	5	8	15	6	1	9—82	2,1	—	—
2SC76	То же	30	10	75	15	—	5	8	15	6	1	9—82	2,1	—	—
2SC77	» »	30	10	75	15	—	5	8	15	6	1	9—82	2,1	—	—
2SC78	» »	30	20	75	15,15*	—	5	2	15	6	1	32—66	1,5	—	—
2SC89	Si, *n-p-n*	120	3	85	25,15*	—	200	8	12	0,2	20	20—100*	25	$t_ф = 0,45$; $t_{выкл} = 0,38$	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ =25° C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ =25° C: $U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ =25° C: $I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	$I_{к.б\,0}$ при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SC90	Ge, *n-p-n*	120	5	85	25,15*	20	400	8	12	0,3	200	20—120*	25	$t_ф = 0,4$; $t_{выкл} = 0,38$	TO5
2SC91	То же	120	10	85	25,12*	20	400	8	12	0,3	200	20—220*	25	$t_ф = 0,36$; $t_{выкл} = 0,35$	TO5
2SC112	Si, *n-p-n*	750	180	175	40,20*	5,0	200	1,0	20	2*	200	35—125*	7	$t_ф = 0,05$; $t_{выкл} = 0,127$	TO5
2SC113	То же	750	180	175	50,25*	5,0	200	1,0	20	2*	200	36—125*	7	$t_ф = 0,05$; $t_{выкл} = 0,127$	TO5
2SC117	» »	(2)	60*	175	75,50*	5,0	600	5	40	15*	30	≥10	33	$t_ф = 0,075$; $t_{выкл} = 0,2$	TO8
2SC118	» »	(2)	70*	175	80	5,0	600	5	40	15*	30	10	33	—	TO8
2SC119	» »	(2)	70*	175	75	—	600	5	40	15*	30	10	33	—	TO8
2SC150	» »	750	100	175	20	5,0	100	1	20	6	10	50	7	—	TO5
2SC151	» »	750	130	175	40	5,0	100	1	20	6	10	50	7	—	TO5
2SC152	» »	750	160	175	60	5,0	100	1	20	6	10	50	7	—	TO5
2SC153	» »	750	350	175	120	40	100	1	120	10	10	40	7	—	TO5
2SC154	» »	750	220*	175	120,70*	5,0	100	6	120	10*	10	11	60	—	TO5
2SC179	Ge, *n-p-n*	120	3	85	25,15*	20	200	8	12	0,2*	20	20—100*	25	$t_ф = 0,47$; $t_{выкл} = 0,38$	TO1
2SC180	То же	120	5	85	25,15*	20	400	8	12	0,3*	200	20—120*	25	$t_ф = 0,4$; $t_{выкл} = 0,38$	TO1
2SC181	» »	120	10	85	25,15*	20	400	8	12	0,3*	200	20—220*	25	$t_ф = 0,3$; $t_{выкл} = 0,43$	TO1
2SC270	Si, *n-p-n*	(50)	22*	150	270,75*	6,0	(5), (1,5)**	(1)	50	3*	2*	24—92*	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2SC281	То же	200	200	175	30,20*	5,0	100	0,1	20	6	10*	60*	10	—	TO1
2SC282	» »	350	200	175	30,20*	5,0	100	1	20	6	10*	60*	10	—	TO1
2SC283	» »	350	200	175	50,20*	5,0	100	1	20	6	10*	35*	10	—	TO1
2SC284	» »	350	200	175	70,35*	5,0	100	1	20	6	10*	35*	10	—	TO1
2SC291	» »	(1)	90*	175	70,40*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	(1)*	25—52*	30	—	—
2SC292	» »	(1)	90*	175	100,60*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	100*	30—173*	30	—	—
2SC293	» »	(1)	90*	175	130,80*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	100*	30—173*	30	—	—
2SC297	» »	(10)	90*	175	70,40*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	(1)*	25—52*	30	—	—
2SC298	» »	(10)	90*	175	100,60*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	100*	30—173*	30	—	—
2SC299	» »	(10)	90*	175	130,80*	5,0	(3), (0,6)**	3	30	2*	100*	30—173*	30	—	—
2SC318	» »	300	—	175	50,30*	5,0	100	0,2	25	3*	1*	33—272*	≤4,5	—	TO18
2SC352	» »	750	—	175	50,30*	5,0	100	0,2	25	3*	1*	26—272*	≤4,5	—	—

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SC353	Si, *n-p-n*	750	—	175	100,60*	5,0	100	0,2	25	3*	1*	26—272*	≤4,5	—	—
2SC401	То же	100	—	120	50,25*	5,0	100	0,2	25	3*	1*	42—272*	≤3,5	—	—
2SC402	» »	100	—	120	50,25*	3,0	100	0,2	25	3*	1*	42—272*	≤3,5	—	—
2SC403	» »	100	—	120	50,25*	3,0	100	0,2	25	3*	1*	26—172*	≤2,7	—	—
2SC404	» »	100		120	50,25*	3,0	50	1,2	25	3*	1*	26—172*	≤2,7	—	—
2SC470—3	» »	750	—	175	90,70*	5,0	100	1	25	5*	3*	13—276*	≤2,5	—	—
2SC470—4	» »	750	—	175	120,100*	5,0	100	1	25	5*	3*	13—276*	≤2,5	—	—
2SC470—5	» »	750	—	175	150,130*	5,0	100	1	25	5*	3*	13—276*	≤2,5	—	—
2SC470—6	» »	750	—	175	180,150*	5,0	100	1	25	5*	3*	13—276*	≤2,5	—	—
2SD44	Ge, *n-p-n*	80	0,5	75	25	12	50	13	12	6*	1*	45—115*	24	$F_ш = 4$	TO1
2SD45	Si, *n-p-n*	(50)	—	150	150,100*	6,0	(5), (1,5)**	—	—	10*	(1)*	12—128*	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2SD46	То же	(50)	—	150	150,75*	6,0	(5), (1,5)**	—	—	10*	(1)*	12—128*	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2SD47	» »	(50)	—	150	100,50*	—	(5), (1,5)**	—	—	10*	(1)*	12—128*	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2SD61	Ge, *n-p-n*	120	1	75	30,12*	10	100	10	25	6	1	32—55	35	$F_ш = 5$	—
2SD62	То же	120	1	75	30,12*	10	100	10	25	6	1	32—55	35	—	—
2SD63	» »	120	1,0	75	25,10*	20	100	10	25	1*	50*	29—57*	35	—	—
2SD64	» »	120	1,0	75	25	20	100	15	25	6	1	45—142	35	$F_ш = 6$	—
2SD65	» »	120	1,0	75	25,10*	20	100	15	25	6	1	25—70	35	$F_ш = 6$	—
2SD66	» »	120	0,8	75	25,10*	20	100	15	25	6	1	14—39	35	То же	—
2SD75	» »	150	4	85	25	12	100	14	25	6*	1	40	—	» »	TO1
2SD75A	» »	150	4,0	85	45	12	100	25	45	6*	1	40	—	» »	TO1
2SD77	» »	150	4,5	85	25	12	100	14	25	1,5*	50	85*	—	—	TO1
2SD77A	» »	150	4,5	85	45	12	100	25	25	1,5*	50	85*	—	—	TO1
2SD120	Si, *n-p-n*	(1)	0,024**	175	60,40*	12	(1,5)	10	30	4*	200*	15—100*	—	$t_{вкл} = 0,9$ $t_{выкл} = 4,2$ $R_{п.к} = 150$	TO5
2SD121	То же	(1)	0,024**	175	100,55	12	(1,5)	10	30	4*	200*	15—100*	—	$t_{вкл} = 0,9$ $t_{выкл} = 4,2$ $R_{п.к} = 150$	TO5
2SD122	» »	(7)	0,6	175	60,40*	12	(3)	15	30	4	750*	15—100*	—	$t_{вкл} = 2,85$ $t_{выкл} = 3,4$ $R_{п.к} = 2,4$	TO8
2SD123	» »	(7)	0,6	175	100,55*	12	(3)	15	30	4	750*	15—100*	—	$t_{вкл} = 2,85$ $t_{выкл} = 3,4$ $R_{п.к} = 21,4$	TO8
2SD124	» »	(21)	0,5	175	60,40*	10	(6)	25	30	4	(1,5)*	10—75*	—	$t_{вкл} = 1,45$ $t_{выкл} = 3,2$ $R_{п.к} = 7,1$	TO3

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_К$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$I_{к.б0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2SD125	Si, *n-p-n*	(21)	0,5	175	100,55*	10	(6)	25	30	4	(1,5)*	10—75*	—	$t_{вкл}=1,45$ $t_{выкл}=3,2$ $R_{п.к}=7,1$	TO3
2SD127	Ge, *n-p-n*	250	4	85	23	20	500	15	15	1*	20*	41—218*	—	—	—
2SD127	То же	250	4	85	23	20	500	15	15	1*	20*	51—173*	—	—	—
2SD128	» »	250	4	85	32	—	500	15	15	1*	20*	41—218*	—	—	—
2SD128A	» »	250	4	85	32	—	500	15	15	1*	20*	51—173*	—	—	—
							Транзы США								
2N34	Ge, *p-n-p*	150	0,4	70	40	—	100	50	—	6*	1*	75	—	—	TO22
2N34A	То же	50	0,6	70	25	—	8	—	—	6	1	60	—	—	—
2N35	» »	150	0,8	70	40	—	50	—	—	6*	1*	75	—	—	TO22
2N36	Ge, *n-p-n*	50	—	75	20	—	8	—	—	6	1	45	—	—	—
2N37	Ge, *p-n-p*	50	—	75	20	—	8	—	—	6	1	30	—	—	OV11
2N38	То же	50	—	75	20	—	8	—	—	6	1	15	—	—	OV11
2N43	» »	240	1,3	85	45	5,0	300	16	—	1	1	42	40	$F_ш \leqslant 8$	RO32
2N43A	» »	240	1,3	85	45	5,0	300	16	—	5	1	42	40	$F_ш \leqslant 8$	RO32
2N44	» »	240	1	85	45	5,0	300	16	—	5	1	25	40	$F_ш \leqslant 8$	RO32
2N44A	» »	155	1	85	25*	5,0	50	8	—	5	1	31	40	—	RO32
2N59	» »	180	1,8	85	25,20*	10	200	15	—	—	100*	90*	40	—	TO5
2N59A	» »	180	1,8	85	40,20*	10	200	15	—	—	100*	90*	40	—	TO5
2N59A	» »	180	1,8	85	40,20*	10	200	15	—	—	100*	90*	40	—	TO5
2N59B	» »	180	1,8	85	60,20*	10	200	15	—	—	100*	90*	40	—	TO5
2N60	» »	180	1,5	85	25,20*	10	200	15	—	—	100*	65*	40	—	TO5
2N60A	» »	180	1,5	85	40,20*	10	200	15	—	—	100*	65*	40	—	TO5
2N60B	» »	180	1,5	85	50,20*	10	200	15	—	—	100*	65*	40	—	TO5
2N60C	» »	180	1,5	85	60,20*	10	200	25	—	—	100*	65*	40	—	TO5
2N61	» »	180	1	85	25,20*	10	200	15	—	—	100*	45*	40	—	TO5
2N61A	» »	180	1	85	40,20*	10	200	15	—	—	100*	45*	40	—	TO5
2N61B	» »	180	1	85	50,20*	10	200	15	—	—	100*	45*	40	—	TO5
2N61C	» »	180	1	85	60,20*	10	200	15	—	—	100*	45*	40	—	TO5
2N63	» »	100	0,6	85	22*	12	10	20	—	6	1	22	—	—	OV3
2N64	» »	100	0,8	85	15*	12	10	20	—	6	1	45	—	—	OV3
2N65	» »	125	1	85	20	16	100	10	—	5	1	75	35	—	—
2N77	» »	35	0,7	50	25,20*	—	15	10	—	4*	70*	55	40	—	TO1

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °С	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ С: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, в	$U_{(проб)э.б\,0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б\,0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N78	Ge, n-p-n	65	9	85	15,15*	5,0	20	3	—	5	1	58	6	—	OV5
2N78A	То же	65	9	85	20,20*	5,0	20	3	—	5	1	58	3	$F_ш = 9 \div 15$	OV5
2N94	» »	150	≥2	85	20	4,5	100	50	—	6*	1*	50*	—	—	TO22
2N94A	» »	150	≥5	85	20	—	100	50	—	6*	1*	20*	—	—	TO22
2N94A	» »	150	≥5	85	20	—	100	50	—	6*	1*	20*	—	—	TO22
2N97	» »	50	1	70	30	—	10	2	—	4,5	1	13	19	—	TO5
2N98	» »	50	2,5	70	40	—	10	2	—	4,5	1	40	14	—	—
2N101/13	Ge, p-n-p	(1)	0,6	70	20	15	(1,5)	(5)	—	2*	(0,5)*	≥11*	—	$R_{п.к} = 12,5$	TO13
2N102/13	Ge, n-p-n	(1)	—	70	30,30*	15	(1,5)	(2)	—	1,5*	(0,5)*	≥11*	—	$R_{п.к} = 12,5$	TO13
2N103	То же	50	0,7	70	35	—	10	50	—	4,5	1	4	20	—	—
2N104	Ge, p-n-p	150	0,7	70	30	12	50	10	—	6,0*	1*	44	40	$F_ш = 9 \div 15$	TO40
2N105	То же	35	0,7	50	25		15	5	—	4*	0,7*	55	17	—	—
2N106	» »	100	0,8	85	15	—	10	—	—	1,5	0,5	45	36	$F_ш = 8$	—
2N107	» »	50	1	50	12	6,0	10	10	—	5	1	19	40	—	RO31
2N108	» »	50	—	70	20	—	15	—	—	6	1	30	—	—	—
2N109	» »	165	—	85	35,25*	12	150	7	—	1*	50*	≥65	≤60	—	TO40
2N111	» »	130	3	85	30	20	200	—	—	6	1	25	12	—	—
2N111A	» »	130	3	85	30	20	200	—	—	6	1	25	12	—	—
2N112	» »	130	5	85	30	20	200	—	—	6	1	30	12	—	—
2N112A	» »	130	5	85	30	20	200	—	—	6	1	30	12	—	—
2N113	» »	130	10	85	30	20	200	—	—	6	1	45	12	—	—
2N114	» »	130	20	85	30	20	200	—	—	6	1	75	12	—	—
2N117	Si, n-p-n	150	4	150	45	1,0	25	2	—	5	1	15	20	—	OV6
2N118	То же	150	5	150	45	1,0	25	2	—	5	1	≥29	20	—	OV6
2N119	» »	150	6	150	45	1,0	35	2	—	5	1	≥63	7	—	OV6
2N120	» »	150	7	150	45	1,0	25	2	—	5	1	200	7	—	OV6
2N122	» »	(9)	0,1	140	120	1,0	(0,14)	100	—	35*	100	≥3*	—	$R_{п.к} = 7,7$	—
2N123	Ge, p-n-p	150	8	85	20,15*	10	125	6	—	1*	10*	≥75	12	$t_{вкл} = 0,63$ $t_{выкл} = 1,25$	RO32
2N124	Ge, n-p-n	50	0,3	70	10	5,0	8	2	—	5	1*	18	10	—	—
2N125	То же	50	5	70	10	5,0	8	2	—	5	1*	36	10	—	—
2N126	» »	50	5	70	10	5,0	8	2	—	5	1	20	14	—	—
2N128	Ge, p-n-p	25	≥28*	85	10	10	5	3	—	3*	0,5*	≥19	≤5	—	TO24
2N130	То же	85	0,7	80	25	12	10	12	—	6	1	24	40	—	TO5
2N131	» »	85	0,8	—	25	12	10	12	—	6	1	50	40	—	TO5
2N132	» »	85	1	—	25	12	10	12	—	6	1	90	40	—	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к,б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N133	Ge, *p-n-p*	85	0,8	—	25	12	10	12	—	6	1	50	40	—	TO5
2N133A	То же	100	0,8	85	30*	12	100	15	—	6	1	50	—	—	—
2N135	» »	100	4,5	85	20	—	50	5	—	5	1	20	14	—	RO31
2N136	» »	100	6,5	85	20	—	50	5	—	5	1	40	14	—	RO31
2N137	» »	100	10	85	10	—	50	5	—	5	1	60	14	—	RO31
2N138	» »	150	—	70	20	—	150	20	—	1*	50*	44	—	—	TO22
2N139	» »	35	13	70	16	0,5	15	10	—	9*	1*	⩽48	9,5	—	TO40
2N140	» »	80	10	70	9*	0,5	15	10	—	9*	0,6*	⩾75	9,5	—	TO40
2N145	Ge, *n-p-n*	65	—	70	20	—	5	3	—	9	1*	—	1	—	—
2N146	То же	65	—	70	20	—	5	3	—	9	1*	—	1	—	—
2N147	» »	65	—	70	12*	—	5	3	—	9	1*	—	1	—	—
2N155	Ge, *p-n-p*	(1,5)	0,18	85	30,15*	15	3	(1)	—	2*	(0,5)*	⩾32* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 3,0	TO3
2N156	То же	(1,5)	⩾0,004	85	30,30*	15	3	(1)	—	2*	(0,5)*	25—32* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 3,0	TO13
2N158	» »	(1,5)	⩾0,004	85	60,60*	30	3	(1)	—	2*	(0,5)*	21—32* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 3,0	TO13
2N158A	» »	(1,5)	⩾0,004	85	80,60*	30	3	(1)	—	2*	(0,5)*	21—32* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 3,0	TO13
2N160	Si, *n-p-n*	150	4	140	40	1,0	25	10	—	5	1	15	7	—	—
2N160A	То же	150	4	140	40	5,0	25	10	—	5	1	15	7	—	—
2N161	» »	150	5	140	40	1,0	25	10	—	5	1	30	7	—	—
2N161A	» »	150	5	140	40	5,0	25	10	—	5	1	30	7	—	—
2N163	» »	150	6	140	40	1,0	25	10	—	5	1	78	7	—	—
2N164A	Ge, *n-p-n*	65	8	85	15,15*	—	20	5	—	1*	0,02	40*	2,4	—	—
2N165	То же	65	5	85	15,15*	—	20	5	—	1*	0,02	72*	2,4	—	—
2N166	» »	25	5	50	6	—	20	5	—	6	1	32	—	—	—
2N167	» »	65	9	85	30,30*	5,0	75	1,5	—	5	1	⩽65	2,5	—	OV5
2N168A	» »	65	8	85	15	—	20	5	—	5*	1	40	24	—	OV5
2N169	» »	65	8	85	15,15	—	20	5	—	5*	1*	72*	2,4	—	OV5
2N170	» »	25	2,5	50	6	—	20	3	—	5*	1	20	4	—	OV5
2N172	» »	65	—	70	16	—	5	3	—	9	1*	—	1	—	—
2N173	Ge, *p-n-p*	(50)	0,01**	85	60	40	(15)*	(4)	—	2	(5)*	35—70*	—	$R_{п.к}$ = 0,5; $t_ф$ = 15	TO36
2N174	То же	(50)	0,01**	85	80	60	(15)*	(4)	—	2	(5)*	25—50*	—	$R_{п.к}$ = 0,5; $t_ф$ = 15	TO36

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_К$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; f_T^*; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_К$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к,б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_К$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N174A	Ge, *p-n-p*	(50)	0,015**	85	80,40*	60	(15)*	(8)	—	2	(1,2)*	40—80*	—	$R_{п.к} = 0,5$; $t_ф = 15$	TO36
2N175	То же	20	0,85	70	10	10	2	12	—	4*	0,5*	65	36	$F_ш \leqslant 8$	TO40
2N176	» »	(90)	0,007**	85	40	—	(3)	(3)	—	2*	(0,5)**	25—90*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N178	» »	(40)	0,006**	85	30,30*	20	(3)	(3)	—	2*	(0,5)*	15—45*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N180	» »	150	0,7	70	30	30	—	10	—	6	1	60	25	—	RO8
2N181	» »	150	0,7	70	30	30	—	10	—	6	1	60	25	—	—
2N182	Ge, *n-p-n*	100	3,8	70	25	15	—	—	—	6	1	25	10	—	RO8
2N183	То же	100	7,5	70	25	15	—	—	—	6	1	40	10	—	RO8
2N184	» »	100	15	70	25	15	—	—	—	6	1	60	10	—	RO8
2N185	Ge, *p-n-p*	150	—	50	20	—	150	14	—	1*	50*	80	—	—	TO22
2N186	То же	100	0,8	85	25	0,5	200	16	—	5	1	25	40	—	RO32
2N187	» »	100	1	85	25	5,0	200	16	—	5	1	35	40	—	RO32
2N187A	» »	200	1	85	25	5,0	200	16	—	1*	100	35*	40	—	RO32
2N188	» »	100	1,2	85	25	5,0	200	16	—	5	1	54	40	—	RO32
2N188A	» »	200	1,2	85	25	5,0	200	16	—	1*	100	54*	40	—	RO32
2N189	» »	200	0,8	85	25*	—	200	16	—	5	1	32	40	$F_ш = 9 \div 15$	RO32
2N190	» »	200	1,0	85	25*	—	200	16	—	5	1	42	40	$F_ш = 9 \div 15$	RO32
2N191	» »	200	1,2	85	25*	—	200	1	—	5	5	67	40	$F_ш = 9 \div 15$	RO32
2N192	» »	200	1,5	85	25*	—	200	16	—	5	1	90	40	$F_ш = 9 \div 15$	RO32
2N193	Ge, *n-p-n*	150	3,0	85	18	5,0	50	50	—	6*	1	7,5	11	—	TO22
2N194	То же	50	3,0	70	18*	—	100	25	—	6*	1	8	11	—	TO22
2N194A	» »	50	3,0	70	18*	—	100	50	—	6*	1	8	11	—	TO22
2N206	Ge, *p-n-p*	75	0,78	85	30	12	50	10	—	5	1	47	35	—	TO1
2N207	То же	85	2,0	50	12,12*	12	20	15	—	5	1	100	40	—	TO5
2N207A	» »	85	2,0	50	12,12*	12	20	10	—	5	1	100	40	—	TO5
2N207B	» »	85	2,0	50	12,12*	12	20	10	—	5	1	100	40	—	TO5
2N211	» »	50	⩾2,0	70	10*	12	50	20	—	6*	10	⩽15	—	—	TO22
2N212	Ge, *n-p-n*	150	⩾4,0	85	18,18*	5,0	100	50	—	6*	1*	20	10	—	TO22
2N213	То же	180	3	85	40	10	100	50	—	6*	1*	80	10	—	TO22
2N213A	» »	180	0,15	85	40	10	100	50	—	6*	1*	185	—	—	TO22
2N214	» »	180	0,8	85	40,25*	10	100	50	—	1,5*	35*	75*	28	—	TO22
2N214A	» »	180	0,1	85	40,25*	10	100	50	—	1,5*	35*	100	28	—	TO5
2N215	Ge, *p-n-p*	150	0,7	70	30	12	50	10	—	6*	1*	44	40	$F_ш = 9 \div 15$	TO1
2N216	Ge, *n-p-n*	50	3	70	18*	—	50	50	—	6*	1*	7,5	11	—	TO22
2N217	Ge, *p-n-p*	150	—	70	25,25*	12	70	14	—	1*	50*	75	—	—	TO1

3—1504

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$I_{к.б0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N218	Ge, p-n-p	35	13	70	16,12*	0,5	0,5	15	—	9*	1*	≤48	9,5	—	TO1
2N219	То же	80	10	70	16,9*	—	15	10	—	9*	0,6*	≥75	9,5	—	TO44
2N220	» »	20	0,8	70	10	10	2	12	—	4*	0,5*	65	36	$F_ш \leq 8$	TO1
2N223	» »	250	0,6	50	18*	—	150	20	—	4,5*	2*	110	—	—	—
2N224	» »	250	0,5	70	25	—	150	25	—	0,6*	100*	90*	—	—	—
2N225	» »	250	0,5	70	25	—	150	25	—	0,6*	100*	100*	—	—	—
2N226	» »	250	0,4	70	30	—	150	25	—	0,6*	100*	60*	—	—	—
2N227	» »	250	0,4	70	30	—	150	25	—	0,6*	100*	75*	—	—	—
2N228	Ge, n-p-n	180	0,6	85	40	10	100	100	—	6*	1*	80	—	—	TO22
2N229	То же	180	≥0,6	85	10	20	100	100	—	6*	1*	75	—	—	TO22
2N231	Ge, p-n-p	9	≥20*	85	5	5,0	3	6	—	3*	0,5*	≥19	≤5,5	—	TO24
2N232	То же	9	$f_{макс}$=20	85	4,5	—	3	6	—	3	0,5	24	2,5	—	TO24
2N233	Ge, n-p-n	150	≥2	85	10,10*	5,0	100	50	—	6*	1	3,5 (тип.)	11	—	TO22
2N233A	То же	150	2	85	18	5,0	100	50	—	6*	1*	15	11	—	TO22
2N235A	Ge, p-n-p	(25)	—	85	50	15	(3)	(1,0)	—	—	(0,5)*	≥40*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2N235B	То же	(25)	—	85	50	15	(3)	(1,0)	—	—	(0,5)*	≥60*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2N236A	» »	—	—	85	50,40*	—	(3)	(1,0)	—	—	(0,75)*	≥40*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2N236B	» »	—	—	85	50,40*	—	(3)	(1,0)	—	—	(0,75)*	≥60*	—	$R_{п.к} = 2,0$	TO3
2N237	» »	150	0,5	85	45	—	20	10	—	6	1	50	—	—	TO22
2N238	» »	150	—	50	20	—	150	20	—	1*	50*	45*	—	—	TO22
2N240	» »	30	$f_{макс}$=30	85	6*	—	15	3	—	3	0,5*	30	2,9	—	TO24
2N241	» »	100	1,3	85	25	—	200	16	—	1	100	73	—	—	RO32
2N241A	» »	100	1,3	70	25	5,0	200	16	—	1*	100*	73*	40	—	RO32
2N242	» »	(25)	5**	85	45,45*	45	(2)	(5)	—	—	—	≤40*	—	$R_{п.к} = 3,0$	MD9
2N243	Si, n-p-n	750	—	140	60,60*	—	60	1	—	10	5	≥9	—	—	—
2N249	Ge, p-n-p	350	—	85	25	—	200	25	—	1	100	50	—	—	—
2N250	То же	(25)	—	85	30	—	(3)	(1)	—	1,5*	(0,5)*	30—90* (тип.)	—	$R_{п.к} = 1,1$	TO3
2N251	» »	(25)	—	85	60	—	(3)	(2)	—	1,5*	(0,5)*	30—90* (тип.)	—	—	TO3
2N251A	» »	(90)	0,16*	85	60,35*	20	(7)	(0,5)	—	1,5*	(3)*	25—100*	—	—	TO3
2N257	» »	(45)	0,05**	85	40	70	(3)	(2)	—	2*	(2)*	≥40*	—	$R_{п.к} = 1,5$	TO3
2N257B	» »	(45)	0,05**	85	40	20	(3)	(5)	—	2*	(2)*	≥50*	—	$R_{п.к} = 1,5$	TO3
2N257G	» »	(45)	0,05**	85	40	20	(3)	(5)	—	2*	(2)*	≥40*	—	$R_{п.к} = 1,5$	TO3
2N257W	» »	(45)	0,05**	85	40	20	(3)	(5)	—	2*	(2)*	≥60*	—	$R_{п.к} = 1,5$	TO3
2N263	Si, n-p-n	125	20	140	45	—	20	50	—	5	10*	45* (тип.)	—	—	—

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C			$I_{к.б0}$, мка (ма)		$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$			$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
					$U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)		при $U_{к.б}$, в	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)				
2N264	Si, n-p-n	125	10	140	45	—	20	50	—	5	10*	20* (тип.)	—	—	—
2N265	Ge, p-n-p	75	1,5	50	25*	—	50	16	—	5	1	115	40	$F_ш = 9 \div 15$	RO32
2N268	То же	(45)	0,06	85	80	40	(3)	(2)	—	2*	(2)*	40* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 1,5	TO3
2N268A	» »	(45)	0,06	85	80	20	(3)	(2)	—	2*	(2)*	20—80*	—	$R_{п.к}$ = 1,5	TO3
2N269	» »	120	4	70	20, 20*	9,0	100	20	—	0,3	20	40	20	—	TO1
2N270	» »	250	—	70	25	12	75	16	—	1*	150*	70*	—	—	—
2N271	» »	130	10	85	30	20	200	—	—	6	1	45	12	—	—
2N271A	» »	130	10	85	30	20	200	—	—	6	1	45	12	—	—
2N272	» »	150	0,5	50	20, 24*	10	100	10	—	5	1	120	40	—	TO5
2N273	» »	150	1	70	20, 30*	10	10	10	—	0,25*	50*	20	40	—	TO5
2N274	» »	80	30	70	35	0,5	10	8	—	12*	1	60	1,7	—	TO44
2N277	» »	(50)	0,01**	85	40, 25*	20	(15)*	(8)	—	2	(5)*	35—70*	—	$t_ф$ = 15	TO36
2N278	» »	(50)	0,01	85	50, 30*	30	(15)*	(4)	—	2	(5)*	35—70*	—	$t_ф$ = 15 $R_{п.к}$ = 0,5	TO36
2N279	» »	125	0,3	85	30*	—	10	12	—	2*	0,5	30	—	—	RO9
2N280	» »	125	0,3	85	30*	—	10	12	—	20*	3*	47	—	—	RO9
2N281	» »	125	0,35	70	16, 16*	10	125	10	—	5,4*	10	70*	—	—	RO8
2N283	» »	125	0,5	70	32	30	10	4,5	—	10*	0,5	40	—	$F_ш = 9 \div 15$	RO8
2N284	» »	125	0,35	70	30*	—	10	12	—	2*	0,5	30	—	—	RO8
2N284A	» »	125	0,35	70	30*	—	10	12	—	20*	3*	47	—	—	RO8
2N292	Ge, n-p-n	65	5	85	15, 15*	—	20	5	—	1*	1*	25*	2,4	—	OV5
2N293	То же	65	8	85	15, 15*	—	20	5	—	1*	1*	25*	2,4	—	OV5
2N296	Ge, p-n-p	(20)	—	85	30, 60*	15	(2)	(1)	—	2*	(1)*	⩾20	—	$R_{п.к}$ = 3,0	TO3
2N297	То же	(45)	⩾0,005**	85	60	9,0	(5)	(5)	—	3*	(2)*	12—40*	—	$R_{п.к}$ = 1,5	TO3
2N297A	» »	(35)	0,012	85	60, 40*	40	(4)*	(3)	—	2	(5)*	40—100*	—	$R_{п.к}$ = 5,0	TO3
2N301	» »	(11)	—	85	40, 40*	10	(1,5)	(3)	—	1,5	(1)*	⩽70*	—	$t_ф$ = 5,0	TO3
2N301A	» »	(11)	—	85	60, 60*	10	(1,5)	(3)	—	1,5	(1)*	⩽70*	—	$R_{п.к}$ = 1,0	TO3
2N302	» »	150	7	85	30, 10*	20	200	1	—	6	1	45	—	$R_{п.к}$ = 1,0	—
2N306	Ge, n-p-n	180	⩾0,6	85	20	10	100	50	—	6*	1*	75	—	—	TO22
2N307	Ge, p-n-p	(50)	0,003*	85	35, 35*	10	(5)	(5)	—	1*	(0,2)*	20—30* (тип.)	—	—	TO3
2N307A	То же	(50)	⩾0,003**	85	35, 35*	10	(5)	(2)	—	1*	(0,2)*	30—35* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 1,5 $R_{п.к}$ = 1,5 $t_{вкл}$ = 1,3	TO3
2N315	» »	150	5	85	20, 15*	20	500	25	—	0,2*	100	20*	14	$t_{выкл}$ = 0,48 $t_{вкл}$ = 1	TO5
2N316	» »	150	12	85	20, 10*	20	500	25	—	0,2*	200	30*	14	$t_{выкл}$ = 1,8 $t_{вкл}$ = 0,5	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, *в*	$U_{(проб)э.б0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N316A	Ge, *p-n-p*	150	12	85	30	20	500	25	—	0,2*	200*	35*	14	$t_{выкл} = 0,5$	TO5
2N317	То же	150	20	85	20,6*	20	400	2	—	0,25*	400*	40*	12	$t_{вкл} = 0,35$; $t_{выкл} = 0,45$	TO5
2N317A	» »	150	20	85	25	20	—	25	—	0,25*	400*	40*	14	$t_{вкл} = 0,35$; $t_{выкл} = 0,45$	TO5
2N319	» »	225	2	85	25	3,0	200	16	—	1*	20*	34	25	—	TO5
2N320	» »	225	0,25	85	25	3,0	200	16	—	1*	20*	50	25	—	TO5
2N321	» »	225	3	85	25	3,0	200	16	—	1*	20*	80	25	—	TO5
2N322	» »	200	3	85	18	5,0	200	16	—	5	1	44	18	—	TO5
2N223	» »	200	3,5	85	18	5,0	200	16	—	5	1	70	18	—	TO5
2N324	» »	200	4	85	18	5,0	200	16	—	5	1	88	18	—	TO5
2N326	Ge, *n-p-n*	(7)	⩾0,15	85	35,35*	—	(2)	(0,3)	—	1*	(1)*	15—60*	—	$R_{п.к} = 8,0$	—
2N327A	Si, *p-n-p*	250	0,2	140	50,40*	20	50	0,1	—	0,5*	3*	⩾15*	70	—	TO5
2N327B	То же	400	⩾2	140	50,40*	20	100	0,001	—	0,5*	0,1*	⩾14	9	—	TO5
2N328A	» »	250	0,3	140	50,35*	20	50	0,1	—	0,5*	3*	⩾30*	70	—	TO5
2N329A	» »	390	0,5	140	50,30*	20	50	0,1	—	0,5*	3,0*	60*	70	—	TO5
2N331	Ge, *p-n-p*	300	100	70	30	12	200	16	—	6*	1	⩾50	36	—	TO9
2N333	Si, *n-p-n*	150	8	140	45	1,0	25	2	—	5	1	29	7	—	TO5
2N334	То же	150	10	140	45	1,0	25	2	—	5	1	54	7	—	TO5
2N335	» »	150	11	140	45	1,0	25	2	—	5	1	63	10	—	TO5
2N336	» »	150	13	170	45	1,0	25	2	—	5	1	200	7	—	TO5
2N344	Ge, *p-n-p*	20	$f_{макс}$=50	50	5,5*	—	5	3	—	3*	0,5*	22	6	—	TO24
2N345	То же	20	$f_{макс}$=50	50	5,5*	—	5	3	—	3*	0,5*	66	6	—	TO24
2N346	» »	20	$f_{макс}$=75	50	5,5*	—	5	3	—	3*	0,5*	⩾10	6	—	TO24
2N350	» »	(10)	0,006**	85	50,40*	—	(3)	3	—	2*	(0,7)*	20—60*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N350A	» »	(90)	0,006**	85	50,40*	—	(3)	3	—	2*	(0,7)*	20—60*	—	$R_{п.к} = 0,8$; $t_ф = 5$	TO3
2N356	Ge, *n-p-n*	150	3,0	70	20	20	500	25	—	0,25*	100	35	14	$t_ф = 1$	TO5
2N357	То же	150	6,0	85	20	20	500	25	—	0,25*	200	30*	14	$t_ф = 0,6$	TO5
2N358	» »	150	9,0	85	20	20	500	25	—	0,25*	300	30*	14	$t_ф = 0,8$; $t_{выкл} = 1,4$	TO5
2N360	Ge, *p-n-p*	170	2,5	85	32	6,0	200	15	—	1*	50	100*	—	—	TO5
2N368	То же	150 (с тепл.)	1,0	70	30	10	50	—	—	5	1	34	—	—	—
2N370	» »	80	30	70	20	1,5	10	20	—	12*	1	60	—	—	TO7

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$; *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N373	Ge, *p-n-p*	80	30	70	25	0,5	10	8	—	12*	1	60	1,6	—	TO7
2N375	То же	(90)	0,01**	85	80,60**	40	(3)	(3)	—	4*	(1)**	35—90*	—	$R_{п.к} = 0,8$; $t_ф = 10$	TO3
2N377	Ge, *n-p-n*	150	6	85	25	15	200	10	—	0,5*	30*	40*	15	$t_ф = 2,5$; $t_{выкл} = 1,7$	TO5
2N378	Ge, *p-n-p*	(50) (с тепл.)	⩾0,005**	85	⩾20	—	(5)	(0,5)	—	2*	(2)**	15—40*	—	$t_ф = 25$; $R_{п.к} = 1,2$	TO3
2N381	То же	225	3	85	50	20	400	10	—	5*	10*	60	20	$F_ш \leqslant 8$	TO5
2N384	» »	120	100	85	40	0,5	10	12	—	12*	1,5	60	2	—	TO44
2N388	Ge, *n-p-n*	150	15	85	25,20*	15	200	10	—	0,5*	30	150*	15	$t_ф = 0,6$	TO5
2N389	Si, *n-p-n*	(85) (с тепл.)	2	140	60*	10	(2)	(10)	—	15*	(1)*	12—60*	—	—	—
2N393	Ge, *p-n-p*	25	50*	85	6,6*	—	50	5	—	3	0,5	155	3,5	—	TO24
2N394A	То же	150	7	85	30	20	200	6	—	1*	10*	70*	12	—	TO5
2N395	» »	200	4,5	85	30	20	200	6	—	1*	10*	85*	12	$t_{вкл} = 0,76$; $t_{выкл} = 0,9$	TO5
2N397	» »	200	12	85	30	20	200	6	—	1*	10*	95*	12	$t_{вкл} = 0,47$; $t_{выкл} = 0,88$	TO5
2N403	» »	180	0,85	85	25	10	200	15	—	9	1	35	40	—	TO5
2N404 2N405	» » » »	150	13	85	25	12	100	20	—	0,2*	24*	40*	12	—	TO5
2N406	» »	150	0,65	70	20,18*	2,5	35	14	2	6*	1	35	40	—	TO44
2N410	» »	80	6,8	70	13	0,5	15	10	—	9	1	48	9,5	—	TO1
2N414	» »	170	7	85	30,15*	20	200	5	—	6*	1	60	12	$F_ш \leqslant 8$	TO5
2N416	» »	170	10	85	30,12*	20	200	5	—	6*	1	80	12	$F_ш \leqslant 8$	TO5
2N417	» »	170	20	85	30,10*	20	200	5	—	6*	1	140	12	—	TO5
2N419	» »	(25) (с тепл.)	0,3	85	55,45*	—	(3)	(1)	—	1,5*	(2,2)*	9—44*	—	—	TO3
2N422	» »	150	0,8	85	35,20*	—	100	15	—	6*	1	50	—	$F_ш \leqslant 8$	TO5
2N424	Si, *n-p-n*	(85) (с тепл.)	3	140	80*	12	(2)	(10)	—	15*	(1)*	12—60*	—	—	—
2N427	Ge, *p-n-p*	170	11	85	30,15*	10	400	4	—	0,25*	1**	55*	14	$t_{вкл} = 0,85$; $t_{выкл} = 1,15$	TO5
2N428	То же	170	17	85	30,12*	20	400	4	—	0,25*	1**	80*	14	$t_{вкл} = 0,85$; $t_{выкл} = 1,1$	TO5
2N439	Ge, *n-p-n*	100	7,5	85	25	25	300	10	—	1*	50*	45	9	—	TO5

Продолжение

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C			$I_{к.б0}$, мка (ма)		$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$			$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
					$U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)		при $U_{к.б}$, в	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)				
2N439A	Ge, *n-p-n*	150	7,5	85	25	25	300	10	—	1*	50*	45	9	—	TO9
2N440A	То же	150	10	85	25	25	300	10	—	1*	50*	70	9	—	TO9
2N441	Ge, *p-n-p*	(50)	0,01**	85	40,25*	20	(15)*	(8)	—	2	(5)*	20—40*	—	$t_ф = 15$ $R_{п.к} = 0,5$	TO36
2N443	То же	(50)	0,01**	85	60,25	40	(15)*	(4)	—	2	(5)*	20—40*	—	$t_ф = 15$ $R_{п.к} = 0,5$	TO36
2N444	Ge, *n-p-n*	150	⩾0,5	85	15	10	50	25	—	4,5*	1	15	16	—	TO5
2N444A	То же	150	⩾0,5	85	40	10	50	25	—	0,25*	20	30*	14	—	TO5
2N445	» »	150	⩾2	85	15	10	50	25	—	4,5*	1	35	16	—	TO5
2N447	» »	150	>9	85	15	10	25	25	—	4,5*	1	125	16	—	TO5
2N456	Ge, *p-n-p*	(50) (с тепл.)	—	70	40,40*	20	(5)	(2)	—	1,5*	(5)*	10—30*	—	$t_ф = 26$ $R_{п.к} = 1,4$	TO3
2N459	То же	(50) (с тепл.)	0,5	85	105	—	(5)	(0,5)	—	2*	(2)*	20—70*	—	$t_ф = 25$ $R_{п.к} = 1,2$	TO3
2N464	» »	170	1	85	45,40*	12	100	15	—	6*	1	26	—	—	TO5
2N479	Si, *n-p-n*	200	39*	140	30,30	2,0	25	0,5	—	6*	1	60	2,4	—	TO5
2N483	Ge, *p-n-p*	150	5,5	85	12	—	20	10	—	6*	1	60	12	—	TO5
2N486	То же	150	12	85	12	—	10	10	—	6	1	100	12	—	TO5
2N495	Si, *p-n-p*	150	8	140	25,25*	—	50	0,001	—	6*	1	9 (тип.)	<12	—	TO1
2N496	То же	150	7,2*	140	10,10*	—	50	0,1	—	6*	1	9 (тип.)	<12	—	TO1
2N499A	Ge, *p-n-p*	60	170*	85	30	0,5	50	15	—	9	1	50	1,3	$F_ш = 9 \div 15$	TO1
2N501	То же	60	175*	85	15	2,0	50	100	—	0,5*	10*	70*	1,8	$t_ф = 0,018$ $t_{выкл} = 0,002$	TO1
2N502	» »	60	260*	85	20	0,5	50	20	—	10*	2	65	1	$F_ш \leqslant 8$	TO9
2N502B	» »	75	$f_{макс}$=620	85	30	—	100	5	—	10*	2	20* (тип.)	1,6	$F_ш \leqslant 8$	TO9
2N507	Ge, *n-p-n*	50	0,6	85	40	—	100	15	—	0,5	10	25 (тип.)	—	—	TO22
2N517	То же	50	3	85	18*	—	10	50	—	6*	1*	7,5	11	—	TO22
2N522	Ge, *p-n-p*	200	18	85	15,8*	10	200	2	—	4,5	1	120	12	—	TO5
2N538	То же	(34) (с тепл.)	⩾0,2*	85	80,60*	28	(3,5)*	(2)	—	2*	(2)*	20—50*	—	$R_{п.к} = 2,2$	MT36
2N540	» »	(34) (с тепл.)	⩾0,2*	85	80,55*	28	(3,5)*	(2)	—	2*	(2)*	45—133*	—	$R_{п.к} = 2,2$	MT36
2N547	Si, *n-p-n*	600	4	140	60,60*	6,0	500	15	—	6*	500*	35*	80	—	TO5
2N554	Ge, *p-n-p*	(40) (с тепл.)	0,06	85	15,16*	—	(3)	(10)	—	2*	(0,5)	50* (тип.)	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N561	То же	(10)	0,65	85	80,65*	60	(5)	(3)	—	2*	(4)*	20—50*	—	$t_ф = 90$ $R_{п.к} = 1,5$	TO3

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^{*}_{т}$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср.}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^{*}_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I^{*}_{э}$; $I^{**}_{б}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	при $U_{к.б}$, $U^{*}_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^{*}_{к}$; $I^{**}_{б}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N563	Ge, *p-n-p*	150	0,8	85	30,20*	10	250	25	—	5*	1	25	30	—	—
2N564	То же	150	0,8	85	30,20*	10	50	25	—	5*	1	25	30	—	TO5
2N565	» »	150	1,0	85	30,20*	10	50	25	—	5*	1	55	55	—	TO5
2N569	» »	150	2,0	85	30,20*	10	50	25	—	5*	1	150	30	—	—
2N570	» »	150	2,0	85	30,20*	10	50	25	—	5*	1	150	30	—	TO5
2N581	» »	150	8	85	18,15*	10	100	20	—	0,3*	20*	30*	12	—	TO5
2N585	Ge, *n-p-n*	120	5	70	25,15*	20	200	8	—	0,2*	20*	40*	17	$t_{вкл} = 0,4$; $t_{выкл} = 0,45$	TO9
2N598	Ge, *p-n-p*	250	⩾5,6*	85	35,35*	30	500	25	—	1*	200*	50*	⩽20	$t_{вкл} = 0,015$; $t_{выкл} = 1,23$	TO5
2N599	То же	250	⩾10*	85	30,20*	20	500	25	—	1*	200*	⩾75*	⩽20	$t_{вкл} = 0,015$; $t_{выкл} = 1,85$	TO5
2N602	» »	120	$f_{макс}$=20	85	20,15*	1,0	100	25	—	1*	0,5**	50*	4,0	$t_ф = 1,2$	TO9
2N603	» »	120	$f_{макс}$=40	85	30,20*	1,0	10	25	—	1*	0,5**	65*	3,0	$t_ф = 0,06$	TO9
2N604	» »	120	$f_{макс}$=60	85	30,20*	2,0	10	25	—	1*	0,5**	90*	3,0	$t_ф = 0,04$	TO9
2N624	» »	100	13	85	30,25	—	10	30	—	10*	2*	⩾20	⩽3	$F_ш = 9 \div 15$	—
2N627	» »	(90) (с тепл.)	0,008**	85	40,30*	20	(10)	(20)	—	2*	(10)*	10—30*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N628	» »	(90) (с тепл.)	0,008**	85	60,45*	30	(10)	(20)	—	2*	(10)*	10—30*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N629	» »	(90) (с тепл.)	0,008**	85	80,60*	40	(10)	(20)	—	2*	(10)*	10—30*	—	$R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N630	» »	(90) (с тепл.)	0,008**	85	100,75*	50	(10)	(20)	—	2*	(10)*	10—30*	—	—	TO3
2N635	Ge, *n-p-n*	150	12	85	20,15*	15	300	15	—	0,75*	200*	⩾25*	12	—	TO9
2N636	То же	150	17	85	20,15*	15	300	15	—	0,75*	200*	⩾35*	12	—	TO9
2N640	Ge, *p-n-p*	80	42	70	34	1,0	10	5	—	12*	1*	60	1,6	—	TO7
2N653	То же	200	1,5	85	30,25*	25	250	15	—	6*	1*	49	10	$F_ш = 9 \div 15$	TO5
2N656	Si, *n-p-n*	(4) (с тепл.)	—	140	60,60*	8,0	(0,3)	100	—	10*	(0,2)*	30—90*	—	$R_{п.к} = 44$	TO5
2N657	То же	(4) (с тепл.)	—	140	100,100*	8,0	(0,3)	100	—	10*	(0,2)*	30—90*	—	$R_{п.к} = 44$	TO5
2N661	Ge, *p-n-p*	210	20	85	30,9*	12	(1)	5	—	0,35*	50*	120*	12	$t_{вкл} = 0,095$	TO5
2N670	То же	300	0,65	85	40	—	(2)	75	—	1,5	(1)	100*	—	$t_{выкл} = 0,195$	RO2

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б 0}$; $U^*_{(проб)к.э 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б 0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N695	Ge, *p-n-p*	75	250*	85	15,15*	3,5	50	3	—	0,3*	10*	40*	3,3	$t_ф = 1,6$; $t_{выкл} = 3,3$	TO17
2N696	Si, *n-p-n*	600	≥64	85	60	5,0	300	1	—	10*	150*	≥20(имп.)	≤35	$t_ф = 0,2$	TO5
2N698	То же	800	≥64	140	120,80*	7,0	—	0,005	—	10*	150*	≥20* (имп.)	≤15	—	TO5
2N702	» »	300	150*	140	25,25*	5,0	50	5	—	5*	10*	40*	3	$F_ш = 9 \div 15$	TO18
2N706	» »	300	≥320	170	25	3,0	200	0,05	—	1*	10*	≥20* (имп.)	≤6	$t_{рас} = 0,06$	TO18
2N718	» »	400	≥80	170	60	5,0	200	1	—	10*	150*	≥40 (имп.)	≤35	$t_ф = 0,2$	TO18
2N735	» »	500	135*	170	80,60*	5,0	100	10	—	5	5	≥30	5	—	TO18
2N744	» »	300	400*	170	20,12*	5,0	200	—	—	0,35*	10*	80*	≤5	$t_{вкл} = 0,016$; $t_{выкл} = 0,045$	TO18
2N753	» »	300	400*	170	25,15*	5,0	200	10	—	1*	10*	80*	3,5	$t_{вкл} = 0,04$; $t_{выкл} = 0,075$	TO18
2N761	» »	500	100	170	45,30*	6,0	100	50	—	20	1*	≥19	4,0	—	TO18
2N768	Ge, *p-n-p*	35	175*	85	12	1,5	100	10	—	0,2*	2*	40*	1,6	—	TO18
2N769	То же	35	900*	85	21,7*	2,0	100	10	—	0,5*	20*	55*	1,5	—	TO18
2N779A	» »	60	450*	85	15	—	100	25	—	0,5*	50*	85	1,4	$t_ф = 0,018$; $t_{выкл} = 0,018$	TO18
2N794	» »	150	40*	85	13,12*	1,0	100	3	—	0,3*	10*	50*	8	$t_{вкл} = 0,3$; $t_{выкл} = 0,25$	TO18
2N796	» »	150	80*	85	13,12*	4,0	100	3	—	0,3*	10*	75*	8	$t_{вкл} = 0,13$; $t_{выкл} = 0,13$	TO18
2N828	» »	150	400*	85	15,15*	2,5	200	100	—	0,3*	10*	40*	3,5	$t_{вкл} = 0,07$; $t_{выкл} = 0,1$	TO18
2N835	Si, *n-p-n*	300	450*	170	25,20*	3,0	200	0,5	—	1*	10*	40*	2,8	$t_{вкл} = 0,2$; $t_{выкл} = 0,035$	TO18
2N842	То же	300	30*	170	45	2,0	50	1	—	5*	1*	20	6	—	TO18
2N858	Si, *p-n-p*	150	14*	140	40,40*	25	50	1	—	0,5*	5*	20*	5	$t_ф = 0,25$; $t_{выкл} = 0,3$	TO18
2N859	То же	150	14*	140	40,40*	25	50	1	—	0,5*	5*	35*	5	$t_{вкл} = 0,2$; $t_{выкл} = 0,25$	TO18
2N860	» »	150	14*	140	25,25*	20	50	1,0	—	0,5*	5*	20*	5	$t_ф = 0,2$; $t_{выкл} = 0,25$	TO18
2N861	» »	150	22*	140	25,25*	20	50	1	—	0,5*	5*	35*	5	$t_ф = 0,15$; $t_{выкл} = 0,25$	TO18

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, в	$U_{(проб)э.б\,0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б\,0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N863	Si, p-n-p	150	22*	140	15, 15*	10	50	1	—	0,5*	5*	35*	5	$t_ф = 0,125$; $t_{выкл} = 0,2$	TO18
2N864	То же	150	22*	140	6, 6*	6,0	50	0,1	—	0,5*	5*	35*	5	$t_ф = 0,1$; $t_{выкл} = 0,2$	TO18
2N865	» »	150	52*	140	10, 6*	10	50	0,1	—	0,5*	5*	75*	5	$t_ф = 0,075$; $t_{выкл} = 0,75$	TO18
2N871	Si, n-p-n	500	≥96	170	100, 60*	7,0	500	0,01	—	10*	150*	130* (имп.)	≤15	—	TO18
2N910	То же	500	≥96	170	100, 60*	7,0	50	0,025	—	5*	1*	125	≤15	$F_ш = 9 \div 15$	TO18
2N914	» »	360	≥480	170	40, 15*	5,0	—	0,025	—	1,0*	10*	55* (имп.)	4,5	$t_{вкл} = 0,04$; $t_{выкл} = 0,04$	TO18
2N918	» »	200	≥960	170	30, 15*	3,0	30	0,01	—	3,0*	30*	≥20*	≤1,7	$F_ш \leq 8$	—
2N923	Si, p-n-p	150	≥0,8	170	40, 25*	40	50	50	—	6*	1*	21	≤20	—	TO18
2N927	То же	150	≥0,8	170	70, 60*	70	50	50	—	6*	1*	15	≤20	—	TO18
2N930	Si, n-p-n	300	≥30*	170	45, 45*	5,0	30	10	—	5*	2*	≥150	≤8	$F_ш \leq 8$	TO18
2N955	Ge, n-p-n	150	1 000*	85	12, 11*	2,0	100	5	—	0,5	30*	60*	4	—	TO18
2N957	Si, n-p-n	250	≥320	140	40, 20*	5,0	30	5	—	5*	10*	≥45* (имп.)	≤6	—	TO18
2N966	Ge, p-n-p	150	460*	85	12, 12*	1,0	100	3	—	0,3*	10*	70*	≤5	$t_{вкл} = 0,05$; $t_{выкл} = 0,1$	TO18
2N990	То же	67	70*	85	32, 32*	1,0	10	8	—	6*	1	150	2,5	—	TO18
2N993	» »	67	70*	85	32, 32*	1,0	10	8	—	6*	1	150	8	—	TO18
2N1000	Ge, n-p-n	150	≥7	85	40, 25*	40	300	15	—	0,5*	100	35*	≤20	$t_ф = 0,7$; $t_{выкл} = 1$	TO5
2N1011	Ge, p-n-p	(45) (с тепл.)	≥0,005*	85	80, 40*	40	(5)	(20)	—	2	(3)*	3—75*	—	$t_ф = 5$; $R_{п.к} = 1,5$	TO3
2N1015	Si, n-p-n	(150) (с тепл.)	0,025**	140	30, 30*	25	(7,5)	(10)	—	4*	(2)*	10—14* (тип.)	—	$t_ф = 6$; $R_{п.к} = 0,7$	—
2N1015C	То же	(150) (с тепл.)	0,025*	140	150, 150*	25	(7,5)	(10)	—	4*	(2)*	10—14* (тип.)	—	$t_ф = 6$; $R_{п.к} = 0,7$	—
2N1028	Si, p-n-p	250	6	170	18, 10*	12	100	0,025	—	6*	1	>9	7	—	TO5
2N1029	Ge, p-n-p	(90) (с тепл.)	0,2	85	50	25	(15)	(15)	—	2*	(10)*	20—60*	—	$t_ф = 15$; $R_{п.к} = 0,8$	—
2N1032	То же	(90) (с тепл.)	0,2	85	50	25	(15)	(15)	—	2*	(10)*	50—100*	—	$t_ф = 15$; $R_{п.к} = 0,8$	TO41
2N1041	» »	400 (с тепл.)	≥0,2*	85	100, 60	20	(3), (1)**	125	—	0,5*	(1)**	20—60*	—	$R_{п.к} = 3,75$	—

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, в	$U_{(проб)э.б\,0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б\,0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	$I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$; ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N1042	Ge, p-n-p	(1)	0,007**	85	40,30*	20	(3), (1)*	(0,65)	—	1*	(3)*	20—60*	—	$R_{п.к}$=3,8	AZ1
2N1043	То же	(1)	0,007**	85	60,40*	20	(3), (1)**	(0,65)	—	1*	(3)*	20—60*	—	$R_{п.к}$=3,8	AZ1
2N1044	» »	(1)	0,007**	85	80,50*	20	(3), (1)*	(0,65)	—	1*	(3)*	20—60*	—	$R_{п.к}$=3,8	AZ1
2N1045	» »	(1)	0,007**	85	100,60*	20	(3), (1)*	(0,65)	—	1*	(3)*	20—60*	—	$R_{п.к}$=3,8	AZ1
2N1068	Si, n-p-n	(10) (с тепл.)	1,5	170	60,30*	12	(1,5) (0,5)**	(0,5)	—	4*	(0,75)*	15—75*	—	$t_ф$=1,6 $R_{п.к}$=15	TO8
2N1099	Ge, p-n-p	(50)	0,01**	85	80,55*	40	(15), (4)**	(4)	—	2	(5)*	37—70*	—	$t_ф$=15 $R_{п.к}$=0,5	TO36
2N1115	То же	150	≥5	85	15*	—	125	6	—	6	1	30	—	—	OV5
2N1118	Si, p-n-p	150	$f_{макс}$=21	140	25,25*	0,1	50	1	—	6*	1	30	6	—	TO5
2N1118A	То же	150	$f_{макс}$=18	140	25,25*	10	50	1	—	6*	1	25	6	—	TO5
2N1119	» »	150	20*	140	10,10*	10	50	0,1	—	0,5	15	25*	6	—	TO5
2N1130	Ge, p-n-p	150	0,75	85	30	—	250	25	—	0,6*	100*	110*	—	—	RO2
2N1150	Si, n-p-n	150	13	170	45	1,0	25	2	—	5	1	24	7	—	—
2N1151	То же	150	14	170	45	1,0	25	2	—	5	1	39	7	—	—
2N1152	» »	150	15	170	45	1,0	25	2	—	5	1	49	7	—	—
2N1153	» »	150	16	170	45	1,0	25	2	—	5	1	99	7	—	—
2N1162	Ge, p-n-p	(90) (с тепл.)	0,004**	85	50	25	(25)	(15)	—	1*	25*	15—65*	—	$t_{вкл}$=19 $R_{п.к}$=0,8	TO3
2N1163	То же	(90) (с тепл.)	0,004**	85	50	25	(25)	(15)	—	1*	25*	15—65*	—	$t_{вкл}$=19 $R_{п.к}$=0,8	TO41
2N1164	» »	(90) (с тепл.)	0,004**	85	80	40	(25)	(15)	—	1*	25*	15—65*	—	$t_{вкл}$=19 $R_{п.к}$=0,8	TO3
2N1165	» »	(90)	0,004**	85	80	40	(25)	(15)	—	1*	25*	15—65*	—	—	TO41
2N1176A	» »	300	0,02**	70	40,40*	—	300	—	—	5*	10*	≥20	40	—	TO5
2N1176B	» »	300	0,02**	70	60,60*	—	300	—	—	5*	10*	≥20	40	—	TO5
2N1183A	» »	(7,5) (с тепл.)	≥0,5	85	60,30*	20	(3), (0,5)**	(0,25)	—	2*	(0,4)*	20—60*	—	$t_ф$=2 $R_{п.к}$=10	TO8
2N1183B	» »	(7,5) (с тепл.)	≥0,5	85	80	20	(3), (0,5)**	(0,25)	—	2*	(0,4)*	20—60	—	$t_ф$=2 $R_{п.к}$=10	TO8
2N1184	» »	(7,5) (с тепл.)	≥0,5	85	45,20*	20	(3), (0,5)**	(0,25)	—	2*	(0,4)*	40—120*	—	$t_ф$=2 $R_{п.к}$=10	TO8
2N1204	» »	200	400*	85	20	4,0	500	7	—	1,5*	400*	30* (имп.)	5	$t_ф$=0,035	—
2N1205	Si, n-p-n	150	≥17*	170	20,20*	1,0	25	5	—	10*	2	10	5	$F_ш$=9÷15	TO5
2N1207	То же	(3) (с тепл.)	20	170	125,125*	3,0	500	1	—	10*	5	35	—	—	TO5
2N1225	Ge, p-n-p	120	100	85	40	0,5	10	12	—	12*	1,5	60	2	—	—

Продолжение

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, ма (а)	$I_{к.б0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N1240	Si, p-n-p	(1)	1,2	140	35, 35*	35	—	0,1	—	2*	10*	14*	95	$F_ш$=9÷15	X3
2N1242	То же	(1)	1	140	60, 60*	60	—	0,1	—	2*	10*	14*	95	$F_ш$=9÷15	X3
2N1277	Si, n-p-n	150	30	170	40, 30*	1,0	25	1	—	5	1*	33	2	—	TO5
2N1300	Ge, p-n-p	150	40*	85	13, 12*	1,0	100	3	—	0,3*	10*	50	—	—	TO5
2N1301	То же	150	60*	85	13, 12*	4,0	100	3	—	0,5	40*	75	—	—	TO5
2N1302	Ge, n-p-n	150	≥3	85	25, 25*	25	300	6	—	1*	10*	≥20*	≤20	$t_{вкл}$=0,82 $t_{выкл}$=1,3	TO5
2N1305	Ge, p-n-p	150	≥5	85	30, 20*	25	300	6	—	1*	10*	≥40*	≤20	$t_{вкл}$=0,36 $t_{выкл}$=1,25	TO5
2N1306	Ge, n-p-n	150	≥10	85	25	25	300	6	—	1*	10*	≥60*	20	$t_{вкл}$=0,3 $t_{выкл}$=0,95	TO5
2N1344	Ge, p-n-p	150	≥7	85	15, 10*	10	400	10	—	1*	20*	90*	12	$t_{вкл}$=1,06 $t_{выкл}$=1,3	TO5
2N1347	То же	150	≥5	85	20	10	200	6	—	1*	10*	80*	12	—	TO5
2N1357	» »	200	≥10	85	30	10	200	6	—	1*	10*	85	12	—	TO5
2N1412	» »	(50)	0,01**	85	100, 65*	60	(4)** (15)*	(4)	—	2	(5)*	25—50*	—	$t_ф$=15 $R_{п.к}$=0,5	TO36
2N1427	» »	25	$f_{макс}$=60	85	6	6,0	50	5	—	3	0,5	120	3,5	$t_ф$=0,03	TO24
2N1484	Si, n-p-n	(25) (с тепл.)	1,25	170	100, 100*	12	3,5 (1,5)**	15	—	4*	(0,75)*	20—60*	—	$t_ф$=1,0 $R_{п.к}$=7	TO8
2N1505	То же	(3) (с тепл.)	$f_{макс}$=250	170	50	3,0	(0,5), (0,2)**	50	—	28*	(0,1)*	7—100* (имп.)	—	$R_{п.к}$=50	TO5
2N1518	Ge, p-n-p	(50) (с тепл.)	0,004**	50	50, 40*	30	(25), (4)**	(4)	—	4*	(15)*	15—40*	—	$t_ф$=20 $R_{п.к}$=0,8	TO36
2N1529	То же	(90) (с тепл.)	0,01**	85	40, 20*	20	(5)	(2)	—	2*	(3)*	20—40*	—	$t_{вкл}$=10 $R_{п.к}$=0,8	TO3
2N1550	» »	(90) (с тепл.)	0,01**	85	60, 30*	30	(15)	(3)	—	2*	(10)*	10—30*	—	$t_{вкл}$=5 $R_{п.к}$=0,8	TO3
2N1555	» »	(90) (с тепл.)	0,006**	85	80, 40*	40	(15)	(3)	—	2*	(10)*	30—60*	—	$t_{вкл}$=10 $R_{п.к}$=0,8	TO3
2N1564	Si, n-p-n	600	120*	170	80, 60*	5,0	100	10	—	5*	5	35	5	—	TO5
2N1586	То же	150	4	120	15	—	25	—	—	5*	1	18	—	—	—
2N1587	» »	150	4	120	30	—	25	—	—	5*	1	18	—	—	—
2N1613	» »	800	130	170	75, 50*	7,0	500	0,01	—	10*	150*	80* (имп.)	≤25	$F_ш$=9÷15 $t_ф$=0,6	TO5
2N1624	Ge, n-p-n	150	8	85	25	15	100	1,0	—	0,5*	30	120*	24	$t_ф$=1	TO5
2N1647	Si, n-p-n	(20) (с тепл.)	10*	170	80, 60*	6,0	(3), (0,5)**	(0,1)	—	10*	(0,5)*	15—45* (имп.)	—	$R_{п.к}$=3,8	MT11

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$, $f_т^*$; $f_{h21б}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б\ 0}$; $U^*_{(проб)к.э\ 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N1654	Si, *p-n-p*	250	0,25	140	100,80*	100	50	1	—	0,5*	1*	30*	50	—	TO5
2N1666	Ge, *p-n-p*	(30) (с тепл.)	0,25	85	80,60*	40	(6),(1)**	(0,1)	—	1*	(6)*	15—30*	—	$t_ф$=20 $R_{п.к}$=1,5	MD3
2N1667	То же	(30) (с тепл.)	0,2	85	32*	2,0	(6)	(0,1)	—	1*	(6)*	≤90* (тип.)	—	$R_{п.к}$=1,5	MD3
2N1668	» »	(30) (с тепл.)	0,2	85	32*	2,0	(6)	(0,1)	—	1*	(6)*	≤50* (тип.)	—	$R_{п.к}$=1,5	MD3
2N1669	» »	(30) (с тепл.)	0,2	85	32*	2,0	(6)	(0,1)	—	1*	(6)*	≤70* (тип.)	—	$R_{п.к}$=1,5	MD3
2N1672	Ge, *n-p-n*	120	≥2	70	40	10	(25)	25	—	5*	1	50	—	—	TO5
2N1683	Ge, *p-n-p*	150	80	85	13,12*	4,0	100	3	—	0,5*	40*	85*	8	—	TO5
2N1691	Si, *n-p-n*	(1)	—	170	120,120*	10	(0,75)	15	—	10*	(0,5)*	20—60*	—	$R_{п.к}$=4,4	MT5
2N1703	То же	(75) (с тепл.)	—	170	60,40*	6,0	(5),(2,5)**	(200)	—	4*	(0,8)*	15—60*	—	$t_ф$=1 $R_{п.к}$=2,33	TO33
2N1709	» »	(15) (с тепл.)	≥150*	170	75	4,0	(2)	10	—	28*	(0,35)*	7,5—75* (имп.)	—	$R_{п.к}$=10	—
2N1711	» »	800	160	170	75,50*	7,0	500	0,01	—	10*	150*	130*	≤25	$F_ш$≤8	TO5
2N1714	» »	800	≥16*	170	60*	6,0	750	—	—	5*	200*	≥20*(имп.)	≤50	—	TO5
2N1720	» »	(2)	16*	170	60*	6,0	(1)	50	—	5*	(0,2)*	40—120*	—	—	—
2N1724	» »	(50) (с тепл.)	10*	170	175,80*	10	(7,5),(5)**	(10)	—	15*	(2)*	20—90* (имп.)	—	$R_{п.к}$=1,5	—
2N1727	Ge, *p-n-p*	60	$f_{макс}$= =100	85	20	0,5	50	10	—	6*	1*	≥20*	≤2,5	—	TO9
2N1746	То же	60	$f_{макс}$= =175	85	20	0,5	50	10	—	6*	1*	60*	1,2	—	TO9
2N1754	» »	50	75*	85	13	—	100	100	—	0,5*	40*	50*	1,5	$t_ф$ = 0,025 $R_{п.к}$ = 2,5	TO9
2N1759	» »	(28) (с тепл.)	≥0,015	85	40	30	(3),(2)**	(3)	—	2*	(0,5)*	60—150*	—	$t_ф$ = 3,5	—
2N1768	Si, *n-p-n*	(40) (с тепл.)	1,25**	170	60,40*	12	(3),(1,5)**	15	—	4*	(0,75)*	31—100*	—	$t_ф$ = 1 $R_{п.к}$ = 4,4	MT5
2N1769	То же	(40) (с тепл.)	1,25**	170	100,55*	12	(3),(1,5)**	15	—	4*	(0,75)*	35—100*	—	$t_ф$ = 1 $R_{п.к}$ = 4,4	MT5
2N1785	Ge, *p-n-p*	45	$f_{макс}$=50	85	10	1,0	50	10	—	6*	1*	≥40*	≤3	—	TO9
2N1788	То же	60	$f_{макс}$= =100	85	35	1,0	50	5	—	12*	1*	≥50*	≤2,5	—	TO9
2N1808	Ge, *n-p-n*	150	14	85	25,25	20	300	5	—	0,25*	20*	125*	13	—	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21б}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср.}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б 0}$; $U^*_{(проб)к.э 0}$, *в*	$U_{(проб)э.б 0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N1812	Si, *n-p-n*	(250) (с тепл.)	0,014**	170	200, 200*	15	(30), (10)**	10	—	4*	(10)*	10—14* (тип.)	—	$t_{вкл}$ = 12, $R_{п.к}$ = 0,45	—
2N1814	То же	(250) (с тепл.)	0,011**	170	300, 300*	15	(30), (10)**	10	—	4*	(10)*	10—12* (тип.)	—	$R_{п.к}$ = 0,45, $t_{вкл}$ = 12	—
2N1837	» »	600	175	170	80	8,0	50	0,5	—	10	50*	9 (тип.)	11	—	TO5
2N1866	Ge, *p-n-p*	60	$f_{макс}$= =200	85	35	0,5	50	10	—	12*	1*	70	1,8	—	TO9
2N1893	Si, *n-p-n*	800	⩾80	170	120, 80*	7,0	200	0,01	—	10*	150*	80*(имп.)	⩽15	—	TO5
2N1900	То же	(125) (с тепл.)	⩾50*	140	140	5,0	(10), (5)**	(25)	—	2*	(10)*	8*(имп.)	—	$R_{п.к}$ = 1	—
2N1905	Ge, *p-n-p*	(50) (с тепл.)	0,075**	85	60, 40*	1,0	(10), (3)**	(0,5)	—	2*	(1)*	50—150*	—	$R_{п.к}$ = 1,5, $t_ф$ = 0,1	TO3
2N1906	То же	(50) (с тепл.)	0,075**	85	100, 40*	1,0	(10), (3)**	(0,5)	—	2*	(5)*	75—200*	—	$R_{п.к}$ = 1,5, $t_ф$ = 0,1	TO3
2N1908	» »	(60) (с тепл.)	20*	85	130, 50*	1,5	(20), (3)*	(10)	—	1,5*	(15)*	20*	—	$R_{п.к}$ = 0,5	TO3
2N1924	» »	225	3	85	60	25	500	10	—	5*	1	44	18	—	TO5
2N1936	Si, *n-p-n*	(150) (с тепл.)	4	170	125, 60*	6,0	(20), (10)**	(10)	—	10*	(10)*	10—50* (имп.)	—	$R_{п.к}$ = 0,5	—
2N1959	То же	600	⩾100*	170	60	5,0	500	(0,1)	—	10*	150*	80* (имп.)	⩽18	$t_{вкл}$ =0,065, $t_{выкл}$ = 0,04	TO5
2N1962	» »	400	⩾200*	170	40, 20*	5,0	200	(0,1)	—	1*	10*	50*	⩽3,5	$t_{вкл}$ = 0,08, $t_{выкл}$ = 0,04	—
2N1969	Ge, *p-n-p*	150	⩾10	85	30, 15*	20	400	25	—	0,25*	0,2**	125	⩽20	$t_{вкл}$ = 1,2, $t_{выкл}$ = 1,3	TO5
2N1970	» »	(150) (с тепл.)	0,01**	85	100, 50*	40	(15), (4)**	(4)	—	2*	(5)*	17—40*	—	$t_ф$ = 15, $R_{п.к}$ = 0,5	TO36
2N1973	Si, *n-p-n*	800	⩾96	180	100, 60*	7,0	—	0,025	—	5*	1*	125	⩽15	—	TO5
2N1982	Ge, *p-n-p*	(170) (с тепл.)	⩾0,003**	70	90, 50*	20	(15)	(6)	—	2*	(5)*	50—100*	—	$R_{п.к}$ = 0,5	TO36
2N1984	Si, *n-p-n*	600	⩾64	140	50, 25*	5,0	—	5	—	5*	1*	⩾35	⩽45	—	TO5
2N1999	Ge, *p-n-p*	250	17	85	30	20	500	25	—	1*	200*	150*	10	—	TO5
2N2015	Si, *n-p-n*	(150) (с тепл.)	0,025**	170	100, 50*	10	(10), (6)**	50	—	4*	(5)*	15—50*	—	$R_{п.к}$ =1,17	TO36
2N2018	То же	(20) (с тепл.)	10*	170	150, 125*	6,0	(2), (0,5)*	(0,1)	—	10*	(0,5)*	20—60* (имп.)	—	$R_{п.к}$ = 3,8	MT11
2N2042	Ge, *p-n-p*	200	⩾0,5	85	105, 105*	6 75	200	25	—	6*	1*	80	⩽25	—	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N2048	Ge, *p-n-p*	150	250*	85	20, 15*	2,0	100	(0,1)	—	0,5*	10*	125*	1,5	$t_ф = 0,06$; $t_{выкл} = 0,21$	TO9
2N2067	То же	(10) (с тепл.)	—	85	40	20	(3), (2)*	(3)	—	14*	0,5*	20*	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2N2075	» »	(170) (с тепл.)	0,01**	70	80, 65*	40	(15)	(4)	—	2	(5)*	20—40*	—	$R_{п.к} = 0,9$; $t_ф = 9$	TO36
2N2082	» »	(170) (с тепл.)	0,01**	70	40	20	(15)	(4)	—	2	(5)*	35—70*	—	$R_{п.к} = 0,5$; $t_ф = 6$	TO36
2N2084	» »	125	100*	85	40	1,0	10	8	—	6*	1*	≥ 40*	≤4	$F_ш = 9 \div 15$	—
2N2090	» »	100	≥ 44*	85	20, 20*	(4), 1,0	11	8	—	6*	1	≥ 40	≤4	—	TO7
2N2092	» »	100	75*	70	32, 32*	(4), 1,0	10	8	—	6*	1	150	4	$F_ш \leq 8$	TO7
2N2100	» »	250	400*	85	40	4,0	500	12	—	1*	200*	70*	15	$t_ф = 0,2$; $t_{выкл} = 0,09$	TO9
2N2101	Si, *n-p-n*	(75) (с тепл.)	1,5	170	60, 60*	10	(3)	—	—	15*	(1)*	15—60 (имп.)	—	$R_{п.к} = 2$	—
2N2102	То же	(5) (с тепл.)	≥ 60*	170	120, 65*	7,0	(1)	0,002	—	10*	(0,15)*	40—120*	—	$F_ш \leq 8$	—
2N2133	» »	(250) (с тепл.)	0,014**	170	200, 200*	15	(30), (10)**	(10)	—	4*	(25)*	10—14* (тип.)	—	$R_{п.к} = 0,45$; $t_{вкл} = 15$	—
2N2138	Ge, *p-n-p*	(63) (с тепл.)	0,012**	85	45, 30*	25	(3)	(2)	—	2*	(0,5)*	30—60	—	$R_{п.к} = 1,2$	TO3
2N2150	Si, *n-p-n*	(30) (с тепл.)	10*	170	125, 80*	8,0	(2), (1)**	10	—	5*	1*	20—60* (имп.)	—	$R_{п.к} = 2,5$	—
2N2154	Ge, *p-n-p*	(170) (с тепл.)	0,003**	50	75, 60*	40	(30)	(4)	—	2*	(5)*	50—100	—	$R_{п.к} = 2,5$	TO36
2N2190	То же	125	125	85	60	2,0	30	50	—	6*	2*	90	1,6	$F_ш \leq 8$	—
2N2194	Si, *n-p-n*	800	130*	170	60, 40*	5,0	(1)	0,01	—	10*	150*	40* (имп.)	≤20	$t_ф = 0,07$; $t_{выкл} = 0,2$	TO5
2N2205	То же	300	≥ 200*	170	25	3,0	200	0,025	—	1*	10*	≥ 20	≤6	$t_{вкл} = 0,04$; $t_{выкл} = 0,075$	TO18
2N2217	» »	800	400*	170	60, 30*	5,0	300	0,01	—	10*	150*	40* (имп.)	4	$t_{вкл} = 0,026$; $t_{выкл} = 0,068$	TO5
2N2220	» »	500	400*	170	60, 30*	5,0	100	0,01	—	10*	150*	40* (имп.)	4	$t_{вкл} = 0,026$; $t_{выкл} = 0,068$	TO18
2N2221A	» »	500	≥ 250*	200	75, 40*	6,0	800	0,01	—	10*	150*	≥ 40* (имп.)	≤8	$F_ш \leq 8$	TO18
2N2235	» »	(10) (с тепл.)	140**	140	40, 20*	6,0	(0,5), (0,1)**	(1)	—	2*	(0,1)*	40—65* (тип.)	—	$R_{п.к} = 10$; $t_ф = 0,19$	TO3

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U_{(проб)к.э0}^*$, в	$U_{(проб)э.б0}$, в	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$I_{к.б0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h_{21Э}^*$ при $U_{к.б}$; $U_{к.э}^*$, в	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$h_{21э}$; $h_{21Э}^*$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N2242	Si, n-p-n	360	300*	170	40,15*	5,0	50	0,1	—	1*	10	80*	6	$F_ш \leqslant 8$	TO18
2N2255	То же	500	≥60	170	45,45*	6,0	100	0,01	—	4*	0,002*	40*	≤8	$F_ш \leqslant 8$	TO18
2N2267	Ge, p-n-p	(50) (с тепл.)	0,2*	110	120,55*	28	5(5), (0,7)**	(2)	—	2*	(2)*	25—75*	8	$R_{п.к} = 2,0$; $t_ф = 8,0$	MT36
2N2273	То же	100	≥200*	85	25,15*	1,0	100	100	—	10*	1	≥20*	3,5	—	TO18
2N2288	» »	(60) (с тепл.)	1,5	110	40	0,75	(10), (1)**	(1)	—	2*	(5*)	20—60*	—	$t_ф = 5$; $R_{п.к} = 0,8$	TO3
2N2303	Si, p-n-p	600	96	170	50,35	5,0	—	1	—	10*	150*	≥75* (имп.)	≤45	—	TO5
2N2311	Si, n-p-n	400	150	200	100	8,0	—	10	—	10*	200*	20*	14	—	—
2N2360	Ge, p-n-p	60	1 600	110	20	0,5	10	10	—	10*	2*	33*	—	$F_ш = 8$	—
2N2377	Si, p-n-p	150	20*	140	25,25*	10	50	1	—	6*	1*	≥15	≤12	—	TO18
2N2378	То же	150	20*	140	10,10*	10	50	0,1	—	0,5*	15*	25*	≤12	—	TO18
2N2400	Ge, p-n-p	150	225*	85	12,7*	1,0	100	100	—	0,5	10*	60	2,2	$t_{вкл} = 0,075$; $t_{выкл} = 0,27$	TO18
2N2405	Si, n-p-n	(1)	≥120*	170	120,90*	—	(1)	0,01	—	10*	(0,15*)	60—200*	—	$R_{п.к} = 58,3$	TO5
2N2412	Si, p-n-p	300	200*	170	25,20*	5,0	100	0,01	—	0,5*	10*	55*	3,7	$t_{вкл} = 0,03$; $t_{выкл} = 0,11$	TO18
2N2415	Ge, p-n-p	75	560*	85	15,10	0,5	20	5	—	6*	2*	45	1,2	$F_ш \leqslant 8$	TO18
2N2440	Si, n-p-n	800	90*	170	120,80*	7,0	500	1	—	10	5	185	≤15	$F_ш \leqslant 8$	TO5
2N2447	Ge, p-n-p	75	1	85	24	4,5	100	10	—	6	1	65	—	—	U8
2N2448	То же	75	1	85	24	(4,5)	100	10	—	6	1	65	—	—	U9
2N2455	» »	150	820*	85	15	2,5	200	100	—	0,2*	2*	52*	3,5	—	TO5
2N2456	» »	150	1 000*	85	15	2,5	200	100	—	0,2*	2*	52*	3,0	—	TO18
2N2477	Si, n-p-n	600	≥250*	170	60,20*	5,0	—	10	—	0,4	150	≥40*	10	$t_{вкл} = 0,025$; $t_{выкл} = 0,045$	TO5
2N2482	Ge, n-p-n	150	≥600*	85	20,12*	3,0	100	100	—	6*	2	≥25*	4,5	$F_ш = 8$	TO18
2N2493	Ge, p-n-p	(170) (с тепл.)	0,01**	110	100,75*	80	(15)	(3)	—	2	(5)*	25—50*	—	$R_{п.к} = 0,5$	TO36
2N2501	Si, n-p-n	360	≥350*	170	40	6,0	—	—	—	1*	10*	≤150*	2,8	$t_{рас} = 0,015$	TO18
2N2509	То же	350	80	170	125,80*	7,0	—	10	—	5	10	≥40*	6	$F_ш \leqslant 8$	TO18
2N2553	Ge, p-n-p	(20) (с тепл.)	≥0,23*	85	60	20	(3), (1)**	(0,125)	—	0,5*	(1**)	20—60*	—	$R_{п.к} = 3,75$	—
2N2565	То же	(20) (с тепл.)	≥0,25*	85	60	20	(3,5), (1)**	(0,125)	—	1*	(3)**	20—60*	100	$R_{п.к} = 3,75$	—
2N2618	Si, n-p-n	600	≥200*	200	60,40*	7,0	750	0,25	—	10*	10*	≥30*	≤14	—	TO5

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, *в*	$U_{(проб)э.б0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N2654	Ge, *p-n-p*	100	250*	85	32	0,5	10	8	—	6	1	50*	1,5	—	TO12
2N2661	То же	(15) (с тепл.)	≥0,28	85	90,50*	20	(3), (1)**	(0,125)	—	0,5	0,5*	30—90*	—	$R_{п.к} = 5$	—
2N2672	» »	100	75*	70	32,32*	1,0	10	8	—	6*	1	150	4	$F_ш \leqslant 8$	TO39
2N2695	Si, *p-n-p*	360	≥100*	170	25,25*	4,0	500	0,025	—	1*	50*	≥30* (имп.)	≤20	$t_{вкл} = 0,075$ $t_{выкл} = 0,17$	TO46
2N2706	Ge, *p-n-p*	280	2,5*	85	32,32*	10	200	10	—	—	50	115*	—	$F_ш \leqslant 8$	TO1
2N2717	То же	100	≥300*	70	120,15*	2,5	30	1,4	—	1*	30*	50*	≤5	$t_{вкл} = 0,015$ $t_{выкл} = 0,15$	TO18
2N2719	Si, *n-p-n*	300	200*	140	25,8*	3,0	200	—	—	0,5*	60*	30*	≤6	—	TO18
2N2727	То же	(1)	≥15*	140	200	10	500	1	—	10*	200*	110* (имп.)	—	—	TO5
2N2729	» »	300	≥900*	140	30,15*	3,0	50	0,01	—	1*	3*	50*	2,4	$F_ш \leqslant 8$	TO46
2N2730	Ge, *p-n-p*	(170) (с тепл.)	0,34*	110	80,60*	3,0	(65), (10)**	(5)	—	2*	(65)*	≥15*	—	$R_{п.к} = 0,5$ $t_ф = 10$	TO36
2N2735	То же	(140) (с тепл.)	0,34*	110	40,30*	20	(65), (10)*	(5)	—	2*	(65)*	15*	—	$R_{п.к} = 0,6$ $t_ф = 10$	—
2N2740	Si, *n-p-n*	(200) (с тепл.)	0,014**	110	100.100*	15	(20), (7,5)**	—	—	4*	(10)*	10*	—	$R_{п.к} = 0,5$ $t_{вкл} = 6$	—
2N2772	То же	(200) (с тепл.)	0,016**	110	200,200*	15	(30), (7,5)**	—	—	4*	(20)*	≥10*	—	$R_{п.к} = 0,5$ $t_ф = 5$	—
2N2782	» »	(15) (с тепл.)	≥140*	140	100	5,0	(2)	(0,5)	—	28*	(0,35)*	7,5—75* (имп.)	—	$R_{п.к} = 10$	—
2N2786	Ge, *p-n-p*	260	≥225*	85	35,20*	0,5	150	10	—	2	100*	≥33*	≤5	—	TO39
2N2787	Si, *n-p-n*	800	400*	170	175,35*	5,0	—	0,01	—	10*	150*	40*	≤8	$t_{вкл} = 0,05$ $t_{выкл} = 0,05$	TO5
2N2792	То же	500	400*	170	75,35*	5,0	—	0,01	—	10*	150*	200	≤8	$t_{вкл} = 0,05$ $t_{выкл} = 0,05$	TO18
2N2800	Si, *p-n-p*	800	≥120*	170	50,35*	50	800	0,1	—	10*	150*	≥30*	25	$t_{вкл} = 0,06$ $t_{выкл} = 0,27$	TO5
2N2809A	Si, *n-p-n*	200	$f_{макс} \geqslant$ ≥1 300	170	30,15*	3,0	25	0,01	—	6*	2*	≥20	≤0,7	$F_ш \leqslant 8$	RO38
2N2814	То же	(70) (с тепл.)	≥15*	170	120,80*	8,0	(10), (2)**	0,1	—	5*	(5)*	40—120*	—	$R_{п.к} = 2,5$ $t_ф = 0,15$	—
2N2823	» »	(200) (с тепл.)	—	170	80,80*	—	(30)	—	—	3*	(20)*	10—40*	—	$R_{п.к} = 0,87$	—
2N2828	» »	(40) (с тепл.)	≥1*	170	80,60*	10	(3), (1)**	(50)	—	4*	(0,5)*	20—60*	—	$R_{п.к} = 4,75$ $t_ф = 1,5$	MT25

Продолжение

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
2N2829	Si, *n-p-n*	(40) (с тепл.)	≥1*	170	80,60*	10	(3)	—	—	4*	(1,0)*	20—60*	—	$R_{п.к}=3{,}33$; $t_{вкл}=1$	MT25
2N2834	Ge, *p-n-p*	(85) (с тепл.)	≥0,01*	110	140,100*	2,0	(20), (5)**	(10)	—	2*	(10)*	25—100*	—	$R_{п.к}=1$; $t_ф=4$	TO3
2N2838	Si, *p-n-p*	500	≥120*	170	50,35*	5,0	—	0,1	—	10*	150*	≥75*	25	$t_{вкл}=0{,}06$; $t_{выкл}=0{,}27$	TO18
2N2869	Ge, *p-n-p*	(30) (с тепл.)	—	85	60,50*	10	(10), (3)**	—	—	2*	(1)*	50—165*	—	$R_{п.к}=1{,}5$	TO3
2N2943	То же	150	≥120*	85	30,15*	2,0	100	25	—	0,5*	50	45*	≤4	$t_{вкл}=0{,}045$; $t_{выкл}=0{,}17$	TO9
2N3216	» »	150	≥90*	85	20,10*	20	500	2	—	0,22*	200*	≥60*	≤20	$t_{вкл}=0{,}35$	TO5

Транзисторы ФРГ

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f^*_т$; $f^{**}_{h21э}$, *Мгц*	$t_п$, °C	$U_{(проб)к.б\,0}$; $U^*_{(проб)к.э\,0}$, *в*	$U_{(проб)э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I^*_э$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$; $I^*_к$; $I^{**}_б$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
AC108	Ge, *p-n-p*	30	1	70	20	—	50	5	—	5*	1*	≥30	25	—	TO1
AC109	То же	30	1	70	20	—	50	5	—	5*	1*	≥50	25	—	TO1
AC110	» »	30	1	70	20	—	50	5	—	5*	1*	≥75	25	—	TO1
AC126	» »	500	≥1,7*	70	32,32*	10	100	200	—	5	2	≥100*	—	$F_ш = 9 \div 15$	TO1
AC128	» »	550	1,5*	85	32,32*	10	(1)	—	—	—	50	≥55	100	—	TO1
AC135	» »	600	1,5	85	20,20*	2,5	200	65	—	5*	2*	90	—	—	TO1
AC139	» »	750	≥1,8	85	32,32*	3,0	500	200	—	1*	400*	40*	40	—	TO1
AC151	» »	150	1,5*	85	32,24*	10	200	25	—	1*	2*	110	27	$F_ш \leqslant 8$	TO1
AC151r	» »	150	1,5*	85	32,24*	10	200	100	—	1*	2*	80	27	$F_ш \leqslant 8$	TO1
AC162	» »	900 (с тепл.)	1,7*	85	32,24*	10	200	25	—	5	2	110*	—	$F_ш \leqslant 8$	TO1
AC163	» »	900 (с тепл.)	2,3*	85	32,24*	10	200	25	—	5	2	160*	—	$F_ш \leqslant 8$	TO1
AD143	» »	(30)	0,45*	50	60	10	(10), (3)**	(5)	—	2*	(1)	100* (тип.)	—	$R_{п.к}=1{,}5$	TO3
AD152	» »	(6) (с тепл.)	0,01**	85	45,30*	12	(1)	30	—	1*	300*	50—150*	—	$R_{п.к}=7{,}5$	MD17
AD155	* »	(6) (с тепл.)	0,01**	85	32,20*	12	(1)	30	—	1*	300*	≥40*	—	$R_{п.к}=7{,}5$	MD17
AF102	» »	50	180*	70	25,25*	—	10	50	—	12*	1	≥20	1,8	$F_ш \leqslant 8$	TO7
AF106	» »	60	≥170*	70	25,18*	0,3	10	10	—	12*	1*	≥10*	1,5	$F_ш \leqslant 8$	TO18

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, мвт (вт)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, Мгц	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср}$ = 25° C: $U_{(проб)к.б 0}$; $U^*_{(проб)к.э 0}$, в	$U_{(проб)э.б 0}$, в	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$I_{к.б 0}$, мка (ма)	при $U_{к.б}$, в	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, в	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, ма (а)	$h_{21э}$; $h^*_{21э}$	$C_к$, пф	Дополнительные сведения	Тип корпуса
AF117	Ge, p-n-p	50	75*	70	20,20*	1,0	10	8	—	6*	1*	≥150	—	$F_ш$≤8	TO7
AF121	То же	100	390	70	25,25*	—	15	8	—	10*	3	≥35*	1,8	—	TO18
BC109	Si, n-p-n	300	≥150*	150	20,20*	—	100	1,5	+20	5*	2*	240—900	4,5	$F_ш$=4	TO18
BC121	То же	90	30*	125	5,5*	5,0	50	0,01	1	0,5*	0,25*	≥50	—	$F_ш$=3	—
BD109	» »	(18,5)	≥30	175	60,40*	5,0	(3), (0,3)**	0,1	40	2*	(1)*	60—170*	≤70		
BF115	» »	145	190*	175	32,32*	4,0	30	5	10	10	1	80		$F_ш$=3	—
ACY16	Ge, p-n-p	800	≥0,37	85	45,30*	10	400	30	—	1*	300*	>40*	—		X9
ACY23	То же	150	1,5*	85	32,30*	16	200	10	—	5*	1*	100	27	$F_ш$≤8	TO1
ACY27	» »	200	1,1	70	40,20*	30	—	12	—	12*	1*	40	16	$F_ш$≤8	—
ACY28	» »	200	1,1	70	40,15*	13	—	12	—	12*	1*	66	16	$F_ш$≤8	—
ACY32	» »	150	1,5*	85	32,30*	16	200	10	—	5*	1*	100	27	$F_ш$≤8	TO1
AFY15	» »	100	20	85	22	8,0	50	10	—	6*	0,5*	80	10	$R_{п.к}$=1,5	—
ADY22	» »	(40) (с тепл.)	0,25	85	30,15*	12	(10), (2)**	—	—	—	(1)*	≥15*	—	$R_{п.к}$=1,5	TO3
ADY23	» »	(40) (с тепл.)	0,25	85	80,40*	12	(10), (2)**	—	—	—	(1)*	≥20*	—	$R_{п.к}$=1,5	TO3
ADY24	» »	(40) (с тепл.)	0,25	85	80,40*	—	(10), (2)**	—	—	—	(1)*	≥50*	—	$R_{п.к}$=0,6 $t_{вкл}$=25	TO3
ADY26	» »	(100) (с тепл.)	0,1**	85	80,60*	40	(30), (5)**	(4)	—	—	(25)	25* (тип.)	—	$R_{п.к}$=1,5	—
ADY27	» »	(30) (с тепл.)	0,45**	100	32,30*	10	(3,5) (0,5)**	—	—	1*	(1)*	30—100*	—	$t_{вкл}$=0,42 $t_{выкл}$=2,17	TO3
ASY27	» »	150	≥6*	85	25,20*	20	200	3	5	—	200	≥20*	≤16	$R_{п.к}$=1,5	TO5
AUY28	» »	(30) (с тепл.)	0,08 кгц**	85	90,65*	24	(6), (1,5)**	(1,5)	—	1,5*	(5)*	33* (тип.)	—	$t_ф$=10	TO3
BCY58	Si, n-p-n	260	50*	175	32,32*	5,0	100	10	32	5*	0,01*	≥40	8	$F_ш$=3	TO18
BFY33	То же	700	80*	200	50	7,0	500	0,02	40	10*	5*	≥35	18	$F_ш$=5	TO5
BSY62	» »	260	≥200*	175	25,15*	5,0	200	0,5	15	1*	10*	40*	5	—	TO18
BUY13	» »	(50) (с тепл.)	11**	150	120,70*	5,0	(8), (2)**	200	80	1,7*	(6)*	25*	—	$R_{п.к}$=1,5	TO3
OC28	Ge, p-n-p	(30) (с тепл.)	0,2	85	80,60*	2,0	(6)	(0,1)	—	—	(6)*	30, ≤90*	—	$R_{п.к}$=1,5	TO3
OC44	То же	83	15	70	15,12*		10	10	—	2	1	100	—	—	RO9
OC65	» »	50	0,45	70	10,10*	10	10	12	—	2	0,5	30	—	$F_ш$=9÷15	OV12
OC66	» »	50	0,47	70	10,10*	10	10	12	—	2	3	47	—	$F_ш$=9÷15	OV12

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{(проб)к.б0}$; $U^*_{(проб)к.э0}$, *в*	$U_{(проб)э.б0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$ при $U_{к.б}$; $U^*_{к.э}$, *в*	при $I_э$, $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h^*_{21Э}$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
OC70	Ge, *p-n-p*	125	0,45	70	30	—	10	5	—	2	0,5	30	—	$F_ш = 9 \div 15$	RO9
OC72	То же	125	0,9	70	32	10	125	10	—	0,7	80	50*	—	$F_ш = 9 \div 15$	RO8
OC75	» »	125	0,75	70	30	—	50	5	—	2	3	90	—	—	RO9
OC77	» »	125	⩾0,35	70	60	10	250	10	—	5,4*	10	⩾45	—	$F_ш = 9 \div 15$	RO8
OC80	» »	550	2	70	32	20	600	10	—	6	50	85	—	—	RO8
OC169	» »	50	70	70	20	0,5	10	13	—	6	1	100	7	$F_ш \leqslant 8$	TO7
OC170	» »	80	$f_{макс}$=75	70	20, 20*	0,5	10	8	—	6*	1	150	5	$F_ш \leqslant 8$	TO7
OC303	» »	110	0,7	70	32, 15*	10	50	10	—	5*	1	26	—	—	RO41
OC304	» »	110	0,8	70	32, 15*	10	50	10	—	5*	1	40	—	—	RO41
Транзисторы ГДР															
GC100 (OC870)	Ge, *p-n-p*	30	2,1	75	15	10	15	15	6	6*	2*	18—114	50	$F_ш \leqslant 25$	TO18
GC101 (OC870)	То же	30	2,1	75	15	10	15	15	6	6*	2*	18—114	50	$F_ш \leqslant 10$	TO18
GC111	» »	120	0,2*	75	80*	10	125	15	6	6*	2*	11—55	—	—	TO18
GC112	» »	120	—	75	80*	10	125	15	6	6*	2*	11—55	—	—	TO18
GC115 (OC815)	» »	70	0,5*	75	20	10	15	15	6	6*	2*	11—22*	—	$F_ш \leqslant 20$	TO18
GC116 (OC816)	» »	70	0,5*	75	20	10	150	15	6	6*	2*	18—114	—	$F_ш \leqslant 20$	TO18
GC117 (OC817)	» »	70	0,5*	75	20	10	150	15	6	6*	2*	18—114	—	$F_ш \leqslant 10$	TO18
GC118 (OC818)	» »	70	0,5*	75	20	10	150	15	6	6*	2*	18—114	—	$F_ш \leqslant 5$	TO18
GC120 OC(820)	» »	150	0,5*	75	20	10	150	15	6	0,7*	80*	11—22*	—	$F_ш \leqslant 20$	TO18
GC121 O C821)	» »	70	0,5*	75	20	10	150	15	6	0,7*	80*	18—72*	—	$F_ш \leqslant 20$	TO18
GC122 (OC822)	» »	75	0,5*	75	30	20	150	15	6	0,7*	125*	18—72*	—	—	TO18
GC123 (OC823)	» »	70	0,5*	75	60	20	150	15	6	0,7*	125*	18—72*	—	—	TO18
GC300	» »	400	0,01**	75	120*	—	(0,5)	20	6	1*	350*	18—72*	—	$R_{п.к} = 75$	TO18
GC301	» »	400	0,01**	75	32	10	(0,5)	20	6	1*	350*	18—72*	—	$R_{п.к} = 75$	TO18
GD100 (OC830)	» »	(1)	0,1*	75	20	10	(1,3), (0,2)**	30	6	6*	100*	10—20*	—	$R_{п.к} = 15$	—

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21э}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{к.б\,0}$; $U_{к.э\,0}^*$, *в*	$U_{э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	при $U_{к.б}$; $U_{к.э}^*$, *в*	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h_{21Э}^*$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
GD110 (OC831)	Ge, *p-n-p*	(1)	0,2*	75	20	10	(1,3) (0,2)**	30	6	2*	500*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD120 (OC832)	То же	(1)	0,2*	75	33	10	(1,3) (0,2)**	30	6	2*	500*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD130 (OC833)	» »	(1)	⩾0,2*	75	66	10	(1,3) (0,2)**	30	6	2*	500*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD150 (OC825)	» »	(4)	⩾0,2*	75	20	10	(3), (0,6)**	50	6	6*	(0,2)*	10*	—	$R_{п.к} = 7{,}5$	—
GD160 (OC836)	» »	(4)	0,2*	75	20	10	(3), (0,6)**	50	6	2*	(1,5)*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD170 (OC837)	» »	(4)	⩾0,2	75	33	10	(3), (0,6)**	50	6	2*	(1,5)*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD180 (OC838)	» »	(4)	⩾0,2	75	66	10	(1), (0,6)**	50	6	2*	(1,5)*	15—39*	—	$R_{п.к} = 15$	—
GD200	» »	(15)	0,2	75	30	—	(6)	150	6	1*	(6)*	20*	—	$R_{п.к} = 2$	MD10
GD210	» »	(15)	0,2	75	60	—	(6)	150	6	1*	(6)*	⩾15*	—	$R_{п.к} = 2$	MD10
GD220	» »	(15)	0,2	75	80	—	(6)	150	6	1*	(6)*	⩾15*	—	$R_{п.к} = 2$	MD10
GF100 (OC871)	» »	30	⩾3	75	15	—	15	10	6	6*	0,5*	20	50	$F_ш = 15$	TO18
GF105 (OC872)	» »	30	10,5	75	15	10	15	10	6	6*	2*	20—110	35	$F_ш = 20$	TO18
GF120 (OC880)	» »	30	30*	75	25	0,5	10	7,5	6	6	0,5	50	15	—	TO18
GF121 (OC881A)	» »	30	50*	75	25	0,5	10	7,5	6	6*	1*	50	10	—	TO18
GF122 (OC882A)	» »	30	50*	75	25	0,5	10	7,5	6	6*	1*	50	10	—	TO18
GF125	» »	30	60*	75	25	0,5	10	7,5	6	6*	1*	⩾50	—	—	TO18
GF127	» »	50	60*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩾40*	—	—	TO18
GF128	» »	50	75*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩾40*	—	—	TO18
GF129	» »	50	75*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩾40*	—	—	TO18
GF130	» »	50	75*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩽40*	—	—	TO18
GF131	» »	50	85*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩾40*	—	—	TO18
GF132	» »	50	85*	75	25	1,0	10	7,5	6	6*	1*	⩾40*	—	$F_ш \leqslant 8$	TO18
GF140	» »	180	300*	100	25	1,0	70	18	15	6*	2*	5—12*	3,5	$F_ш = 18$	TO5
GF141	» »	180	300*	100	25	1,0	70	18	15	6*	2*	5—12*	3,3	$F_ш = 18$	TO5
GF142	» »	180	300*	100	25	1,0	70	18	15	6*	2*	5—12*	3,5	$F_ш = 18$	TO5

Продолжение

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21б}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{к.б\,0}$; $U_{к.э\,0}^*$, *в*	$U_{э.б\,0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\,0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h_{21э}^*$ при $U_{к.б}$; $U_{к.э}^*$, *в*	$I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h_{21э}^*$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
GF143	Ge, *p-n-p*	180	260	100	25	—	70	18	15	6*	2*	5—12*	3,3	$F_ш = 18$	TO5
GS100 (OC874)	То же	30	15	75	25	15	150 (имп.)	100	6	0,5*	50*	29—72*	—	—	TO18
GS110	» »	100	0,5	75	20	—	300 (имп.)	25	10	0,5*	300*	29—114*	—	—	TO18
GS111 GS112	» » » »	100	1	75	20	10	300 (имп.)	20	20	0,5*	300*	29—114*	—	—	TO18
LC810	» »	25	0,2	65	10*	—	15	30	—	—	—	10—80	—	$I_{к.н} = 1$	RO48
LC815 (LA25)	» »	100	0,2	65	10*	—	50	30	—	—	—	10—80	—	$I_{к.н} = 1$	RO48
LC820 (LA50)	» »	100	0,2	65	10*	—	50	30	—	—	—	10—80	—	$I_{к.н} = 1$	RO48
LC824 (LA100)	» »	150	0,2	65	10*	—	150	30	—	—	—	10—80	—	$I_{к.н} = 1$	RO48
LD830 (LA1)	» »	(1)	0,2	—	10*	—	1	50	—	—	—	10—80	—	$I_{к.н} = 2$	—
LD835 (LA4)	» »	(4)	—	—	10*	—	(3)	100	—	—	—	10—50	—	$I_{к.н} = 4$	—
LF129	» »	—	—	—	10*	—	10	100	—	—	—	10	—	—	RO96
LF130	» »	—	8	—	26*	—	10	100	—	—	—	—	—	—	RO96
LF132	» »	—	100	—	13*	—	10	100	—	—	—	—	—	—	RO96
LF841	» »	180	180	—	10*	—	70	100	—	—	—	7	—	—	TO5
LF871 (LA30)	» »	30	≥3	—	10*	—	15	30	—	—	—	20—100	—	$I_{к.н} = 1,5$	TO5
LF880 (LA40)	» »	—	≥10*	—	10*	—	10	15	—	—	—	—	—	—	TO18
LF881 (LA40)	» »	—	≥10*	—	10*	—	10	15	—	—	—	—	—	—	TO18
OC810	» »	25	0,3	65	20*	—	10	15	5	—	—	16	—	—	TO18
OC811	» »	25	0,3	65	20*	—	15	15	5	—	—	40	—	—	TO18
OC812	» »	25	0,3	65	20*	—	15	15	5	—	—	34	—	$F_ш \geq 10$	TO18
OC813	» »	25	1	65	20*	—	15	15	5	—	—	40	—	$F_ш = 25$	TO18
OC814	» »	25	0,3	75	20*	—	15	15	5	—	—	32	—	$F_ш \leq 5$	TO18
OC824	» »	150	0,3	75	20*	—	150	15	6	—	—	10—70	—	$F_ш \leq 25$	RO3
OC825	» »	150	0,3	75	20*	—	150	15	6	—	—	>20	—	$F_ш \geq 25$	RO3

6—1504

Тип транзистора	Материал, полярность	$P_к$, *мвт* (*вт*)	$f_{h21б}$; $f_т^*$; $f_{h21б}^{**}$, *Мгц*	$t_п$, °C	Максимальные значения при $t_{окр.ср} = 25°$ C: $U_{к.б\ 0}$; $U_{к.э\ 0}^*$, *в*	$U_{э.б\ 0}$, *в*	$I_к$; $I_э^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$I_{к.б\ 0}$, *мка* (*ма*)	при $U_{к.б}$, *в*	$h_{21э}$; $h_{21Э}^*$ при $U_{к.б}$; $U_{к.б}^*$, *в*	при $I_э$; $I_к^*$; $I_б^{**}$, *ма* (*а*)	$h_{21э}$; $h_{21Э}^*$	$C_к$, *пф*	Дополнительные сведения	Тип корпуса
OC826	Ge, *p-n-p*	150	0,3	75	20*	—	150	15	6	—	—	>20	—	$F_ш \geqslant 10$	RO3
OC827	То же	150	0,3	75	20*	—	150	15	6	—	—	>20	—	$F_ш \leqslant 5$	RO3
OC828	» »	150	0,3	75	30*	—	150	15	6	—	—	>20	—	—	RO3
OC829	» »	150	0,3	75	60*	—	150	15	6	—	—	>20	—	—	RO3
SC100	Si, *p-n-p*	250	2,3	150	10*	(1),10	200 (имп.)	0,1	6	6*	1*	8—22	60	$F_ш = 15$	TO5
SC103	То же	250	4,2	150	10*	(1,3)	(200) (имп.)	0,1	6	6*	1*	18—35	70	$F_ш = 15$	TO5
SC104	» »	250	6	150	10*	(1,3)	200 (имп.)	0,1	6	6*	1*	20—55	70	$F_ш = 15$	TO5
SF111	Si, *n-p-n*	400	40*	150	30*	—	200	1	20	62	100	12—55*	75	—	TO5
SF112	То же	400	40*	150	30*	—	200	1	20	2	100	12—55*	75	—	TO5
SF113	» »	400	40*	150	60	—	200	1	20	2	100	12—55*	75	—	TO5
SF114	» »	400	40*	150	100	—	200	1	20	2	100	12—55*	75	—	TO5
SF121	» »	520	120*	175	20	5	100	1	20	6*	2*	45	25	—	TO5
SF122	» »	520	120*	175	33	5	100	1	33	6*	2*	45	25	—	TO5
SF123	» »	520	120*	175	66	5	100	1	66	6*	2*	45	20	—	TO5
SL112	» »	(15)	40*	150	30*	—	400	1	30	2	100*	12—55	75	—	MD18
SL113	» »	(15)	40*	150	60*	—	400	1	60	2*	100*	12—55	75	—	MD18
SL114	» »	(15)	40*	150	100*	—	400	1	100	2*	100*	12—55	75	—	MD18
SS101	Si, *p-n-p*	250	1,9	150	33*	—	200 (имп.)	0,1	6	6*	1*	8—22	70	$F_ш = 15$	TO5
SS102	То же	250	1,9	150	66*	—	200 (имп.)	0,1	6	6*	1*	8—22	20	$F_ш = 15$	TO5

6* 6*

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

OV5

Рис. 9.

OV6

Рис. 10.

OV11

Рис. 11.

OV12

Рис. 12.

R02

Рис. 13

R03

Рис. 14.

Цветная метка

R08

Рис. 15.

Цветная метка

R09

Рис. 16.

ϕ6,1
48
11
Метка
Б
Э
К
R016

Рис. 17.

ϕ4
35
5,5
Метка
Б
Э
К
R018

Рис. 18.

ϕ8,3
4,5
46,5
Э Б
К
R031

Рис. 19.

ϕ8,45
6,35
44,5
К Б Э
R032

Рис. 20.

ϕ4,7
4,83
17,5
Б
Э
К
Корпус
R038

Рис. 21.

ϕ5,1
8,5
4,5
Цветная метка
Б
Э
К
R041

Рис. 22.

ϕ4,7
8
26
Б
Э
К
R048

Рис. 23.

ϕ5,5
10,5
51
Б
Э
К
R062

Рис. 24.

ϕ5
8,8
21,5
Э
Б
К
Корпус
R096

Рис. 25.

ϕ6,1
10,5
48,5
Б
К
Э
T01

Рис. 26.

ТО3

Рис. 27.

ТО5

Рис. 28.

ТО7

Рис. 29.

ТО8

Рис. 30.

ТО9

Рис. 31.

ТО13

Рис. 32.

ТО17

Рис. 33.

ТО18

Рис. 34.

ТО 22

Рис. 35.

ТО 24

Рис. 36.

ТО 36

Рис. 37.

ТО 39

Рис. 38.

ТО 40

Рис. 39.

ТО 41

Рис. 40.

ТО 44

Рис. 41.

ТО 46

Рис. 42.

Рис. 43.

Рис. 44.

Рис. 45.

Рис. 46.

Рис. 47.

Леонтьев Валентин Федорович

Зарубежные транзисторы
широкого применения

Редактор *В. Б. Пускин*
Обложка художника *А. М. Кувшинникова*
Технический редактор *Н. С. Мазурова*
Корректор *А. Д. Халанская*

Сдано в набор 13/X 1967 г. Под. к печ. 22/V 1968 г.
Т-08325 Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2
Усл. печ. л. 4,62 Уч.-изд. л. 5,0
Тираж 75 000 экз. Цена 20 коп. Зак. 1504

Издательство „Энергия". Москва, Ж-114,
Шлюзовая наб., 10.

Владимирская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б.